

PCT/JP 2004/007515

日 本 国 特 許 庁  
JAPAN PATENT OFFICE

03.06.2004

別紙添付の書類に記載されている事項は下記の出願書類に記載されている事項と同一であることを証明する。

This is to certify that the annexed is a true copy of the following application as filed with this Office.

出 願 年 月 日  
Date of Application: 2 0 0 3 年 6 月 9 日

出 願 番 号  
Application Number: 特 願 2 0 0 3 - 1 6 3 8 6 6  
[ST. 10/C]: [ J P 2 0 0 3 - 1 6 3 8 6 6 ]

出 願 人  
Applicant(s): J S R 株式会社

REC'D 22 JUL 2004

WIPO

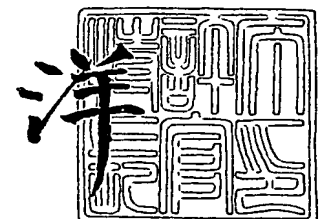
PCT

PRIORITY DOCUMENT  
SUBMITTED OR TRANSMITTED IN  
COMPLIANCE WITH  
RULE 17.1(a) OR (b)

2 0 0 4 年 7 月 8 日

特許庁長官  
Commissioner,  
Japan Patent Office

小 川



出証番号 出証特 2 0 0 4 - 3 0 5 9 0 8 9

【書類名】 特許願

【整理番号】 JSR10234

【提出日】 平成15年 6月 9日

【あて先】 特許庁長官殿

【国際特許分類】 G01R 31/00  
H01L 21/66

【発明者】

    【住所又は居所】 東京都中央区築地五丁目 6 番 1 0 号 ジェイエスアール  
                        株式会社内

    【氏名】 五十嵐 久夫

【発明者】

    【住所又は居所】 東京都中央区築地五丁目 6 番 1 0 号 ジェイエスアール  
                        株式会社内

    【氏名】 佐藤 克己

【発明者】

    【住所又は居所】 東京都中央区築地五丁目 6 番 1 0 号 ジェイエスアール  
                        株式会社内

    【氏名】 井上 和夫

【特許出願人】

    【識別番号】 000004178

    【氏名又は名称】 ジェイエスアール株式会社

【代理人】

    【識別番号】 100078754

    【弁理士】

    【氏名又は名称】 大井 正彦

【手数料の表示】

    【予納台帳番号】 015196

    【納付金額】 21,000円

【提出物件の目録】

【物件名】 明細書 1

【物件名】 図面 1

【物件名】 要約書 1

【包括委任状番号】 0111576

【プルーフの要否】 要

【書類名】 明細書

【発明の名称】 異方導電性コネクタおよびウエハ検査装置

【特許請求の範囲】

【請求項 1】 面方向に沿って互いに離間して配置された厚み方向に伸びる複数の接続用導電部およびこれらの接続用導電部の間に形成された絶縁部よりなる弾性異方導電膜と、この弾性異方導電膜を支持するフレーム板とよりなり、

前記フレーム板は、線熱膨張係数が  $3 \times 10^{-6} \sim 2 \times 10^{-5} \text{K}^{-1}$  の金属材料よりなり、

前記弾性異方導電膜における接続用導電部は、弾性高分子物質中に数平均粒子径が  $20 \sim 80 \mu\text{m}$  の磁性を示す導電性粒子が密に充填されてなり、当該導電性粒子は、表面に厚みが  $20 \text{ nm}$  以上の貴金属よりなる被覆層が形成されてなり、当該接続用導電部のデュロメータ硬さが  $10 \sim 35$  であり、互いに隣接する接続用導電部間における電気抵抗が  $10 \text{ M}\Omega$  以上であることを特徴とする異方導電性コネクタ。

【請求項 2】 フレーム板は、少なくとも一つの厚み方向に伸びる貫通孔を有し、弾性異方導電膜は、その接続用導電部が前記フレーム板の貫通孔内に位置するよう配置されていることを特徴とする請求項 1 に記載の異方導電性コネクタ。

【請求項 3】 フレーム板は、それぞれ厚み方向に伸びる複数の貫通孔を有し、弾性異方導電膜は、その接続用導電部が前記フレーム板の各貫通孔内に位置するよう配置されていることを特徴とする請求項 1 に記載の異方導電性コネクタ。

【請求項 4】 接続用導電部を  $20 \text{ g}$  の荷重で厚み方向に加圧した場合における当該接続用導電部の許容電流値が  $1 \text{ A}$  以上であることを特徴とする請求項 1 乃至請求項 3 のいずれかに記載の異方導電性コネクタ。

【請求項 5】 接続用導電部をその歪み率が  $20\%$  となるよう厚み方向に加圧した場合における当該接続用導電部の許容電流値が  $1 \text{ A}$  以上であることを特徴とする請求項 1 乃至請求項 4 のいずれかに記載の異方導電性コネクタ。

【請求項 6】 接続用導電部を  $20 \text{ g}$  の荷重で厚み方向に加圧した状態で測

定される当該接続用導電部の厚み方向における電気抵抗が $0.1\Omega$ 以下であり、温度 $80^{\circ}\text{C}$ の環境下で、接続用導電部を $20\text{g}$ の荷重で厚み方向に $15$ 分間加圧し、次いで、加圧を解除した状態で $5$ 分間保持するサイクルを $3000$ 回繰り返し、その後において、当該接続用導電部を $20\text{g}$ の荷重で厚み方向に加圧した状態で測定される当該接続用導電部の厚み方向における電気抵抗が $0.1\Omega$ 以下であることを特徴とする請求項 $1$ 乃至請求項 $5$ のいずれかに記載の異方導電性コネクタ。

【請求項 $7$ 】 接続用導電部を歪み率が $20\%$ となるよう厚み方向に加圧した状態で測定される当該接続用導電部の厚み方向における電気抵抗が $0.1\Omega$ 以下であり、温度 $80^{\circ}\text{C}$ の環境下で、接続用導電部を歪み率が $20\%$ となるよう厚み方向に加圧した状態で当該接続用導電部に $1\text{A}$ の電流を $3000$ 時間印加させた後に測定される当該接続用導電部の厚み方向における電気抵抗が $0.1\Omega$ 以下であることを特徴とする請求項 $1$ 乃至請求項 $6$ のいずれかに記載の異方導電性コネクタ。

【請求項 $8$ 】 ウエハに形成された多数の集積回路の電氣的検査を行うためのウエハ検査装置であって、

表面に多数の検査用電極を有する検査用回路基板と、

裏面に前記検査用回路基板の検査用電極のパターンに対応するパターンに従って複数の端子電極が形成された接続用回路基板、およびこの接続用回路基板の表面に設けられた、検査対象であるウエハにおける集積回路の被検査電極に接触される多数の接触子が配置されてなる接触部材を有し、当該接続用回路基板の端子電極の各々が前記検査用回路基板の検査用電極に対向するよう配置されたプローブカードと、

前記検査用回路基板と前記プローブカードにおける接続用回路基板との間に配置され、当該検査用電極の各々と当該端子電極の各々とを電氣的に接続する、請求項 $1$ 乃至請求項 $7$ に記載の異方導電性コネクタとを具備することを特徴とするウエハ検査装置。

【請求項 $9$ 】 異方導電性コネクタにおける弾性異方導電膜が検査用回路基板と接続用回路基板とによって挟圧された状態で、当該検査用回路基板、当該異

方導電性コネクタおよび当該接続用回路基板の三者が固定されており、これにより、当該検査用回路基板における検査用電極の各々と当該接続用回路基板における端子電極の各々とが当該異方導電性コネクタにおける接続用導電部を介して電氣的に接続されていることを特徴とする請求項 8 に記載のウエハ検査装置。

【請求項 10】 検査用回路基板を加圧することによって、プローブカードにおける接触部材の接触子の各々を検査対象であるウエハにおける被検査電極の各々に電氣的に接続するための加圧機構を具えてなり、

当該加圧機構によって検査用回路基板が加圧されることにより、当該検査用回路基板と接続用回路基板とによって異方導電性コネクタにおける弾性異方導電膜が挟圧され、これにより、当該検査用回路基板における検査用電極の各々と当該接続用回路基板における端子電極の各々とが当該異方導電性コネクタにおける接続用導電部を介して電氣的に接続されることを特徴とする請求項 8 に記載のウエハ検査装置。

【発明の詳細な説明】

【0001】

【発明の属する技術分野】

本発明は、ウエハ検査装置およびこのウエハ検査装置に好適に用いることができる異方導電性コネクタに関し、更に詳しくは、ウエハに形成された多数の集積回路の一部若しくは全部について一括してプローブ試験を行うためのウエハ検査装置、またはウエハに形成された多数の集積回路の一部若しくは全部について一括してバーンイン試験を行うためのウエハ検査装置、およびこれらのウエハ検査装置に好適に用いることができる異方導電性コネクタに関するものである。

【0002】

【従来の技術】

一般に、半導体集積回路装置の製造工程においては、ウエハ上に多数の集積回路を形成した後、これらの集積回路の各々についてプローブ試験が行われる。次いで、このウエハを切断することによって半導体チップが形成され、この半導体チップが適宜のパッケージ内に収納されて封止され、更に、パッケージ化された半導体集積回路装置の各々について、バーンイン試験が行われる。而して、半導

体集積回路装置の品質保証を行うためには、バーンイン試験によって、当該半導体集積回路装置の電気的特性の検査を行うことのみならず、半導体チップ自体の電気的特性の検査を行うことが極めて重要である。また、近年、半導体チップ自体を集積回路装置として用い、当該半導体チップよりなる回路装置を例えばプリント回路基板上に直接実装する実装法が開発されており、そのため、半導体チップ自体の品質保証を行うことが要請されている。

#### 【0003】

然るに、半導体チップは微小なものであってその取扱いが不便なものであるため、半導体チップよりなる回路装置の検査を行うためには、長い時間を要し、また、検査コストが相当に高くなる。

このような理由から、最近において、半導体チップよりなる回路装置の電気的特性の検査をウエハの状態で行うWLB I (Wafer Level Burn-in) 試験が注目されている。

#### 【0004】

一方、ウエハ上に形成された集積回路に対して行われるプローブ試験においては、一般に、ウエハ上に形成された多数の集積回路のうち例えば16個または32個の集積回路について一括してプローブ試験を行い、順次、その他の集積回路についてプローブ試験を行う方法が採用されている。

而して、近年、検査効率を向上させ、検査コストの低減化を図るために、ウエハ上に形成された多数の集積回路のうち例えば64個、124個または全部の集積回路について一括してプローブ試験を行うことが要請されている。

#### 【0005】

図12は、多数の集積回路が形成されたウエハについてWLB I 試験またはプローブ試験を行うための従来のウエハ検査装置の一例における構成の概略を示す説明用断面図である。このようなウエハ検査装置は、例えば特許文献1および特許文献2に記載されている。

このウエハ検査装置は、表面（図において下面）に多数の検査用電極81が形成された検査用回路基板80を有し、この検査用回路基板80の表面には、コネクター85を介してプローブカード90が配置されている。このプローブカード

90は、接続用回路基板91と、この接続用回路基板90の表面（図において下面）に設けられた、検査対象であるウエハ1における集積回路の被検査電極（図示省略）に接触される多数の接触子（図示省略）を有する接触部材95とにより構成されている。接触部材95の下方には、検査対象であるウエハ1が載置される、加熱板を兼ねたウエハトレイ96が配置されている。また、97は、検査用回路基板80を下方に加圧する加圧機構である。

#### 【0006】

プローブカード90における接続用回路基板91の裏面には、検査用回路基板80の検査用電極81のパターンに対応するパターンに従って多数の端子電極92が形成され、当該接続用回路基板91は、ガイドピン93によって、端子電極92の各々が検査用回路基板80の検査用電極81に対向するよう配置されている。

コネクタ85においては、「ポゴピン」と称される長さ方向に弾性的に圧縮し得る多数の接続ピン86が、検査用回路基板80の検査用電極81のパターンに対応するパターンに従って配列されている。そして、コネクタ85は、接続ピン86の各々が、検査用回路基板80の検査用電極81と接続用回路基板91の端子電極92との間に位置された状態で配置されている。

#### 【0007】

図12に示すウエハ検査装置においては、検査対象であるウエハ1がウエハトレイ96上に載置され、検査用回路基板80が加圧機構97によって下方に加圧されることにより、コネクタ85の接続ピン86の各々が長さ方向に弾性的に圧縮され、これにより、検査用回路基板80の検査用電極81の各々と接続用回路基板91の端子電極92の各々とが電氣的に接続されると共に、ウエハ1に形成された一部の集積回路の被検査電極の各々に、接触部材95の接触子の各々が接触し、これにより、所要の電氣的接続が達成される。そして、ウエハトレイ96によってウエハ1が所定の温度に加熱され、この状態で、ウエハ1についての所要の電氣的検査（WLB I 試験またはプローブ試験）が行われる。

#### 【0008】

しかしながら、図12に示す従来のウエハ検査装置においては、以下のような

問題がある。

すなわち、このウエハ検査装置においては、検査用回路基板 80 の検査用電極 81 と接続用回路基板 91 の端子電極 92 との安定な電氣的接続を達成するために、接続ピン 86 の各々を例えば 1 個当たり 0.8 N (約 0.08 kgw) 程度の加圧力で加圧することが必要であり、従って、例えば検査用回路基板 80 の検査用電極 81 の数が例えば 5000 個である場合には、全体で 4000 N 程度の加圧力が必要となる。そのため、このような加圧力を作用させるための加圧機構 97 は必然的に大型のものとなって、ウエハ検査装置全体が相当に大型のものとなる、という問題がある。

#### 【0009】

また、検査用回路基板 80 の検査用電極 81 の各々が接続ピン 86 によって大きい加圧力で加圧されることによって、当該検査用電極 81 の各々が損傷しやすくなるため、検査用回路基板 80 の使用寿命が短くなり、延いては、検査コストが増大する、という問題がある。

また、機構上の制約から、接続ピン 86 の長さを小さくすることには限界があり、實際上接続ピンには 3 cm 程度の長さが必要とされる。そのため、検査用回路基板 80 と接続用回路基板 91 との離間距離が相当に長いものとなる結果、ウエハ検査装置の高さ方向の寸法を小さくすることが困難であり、この点からも、ウエハ検査装置全体の小型化を図ることができない、という問題がある。特に、最近においては、複数のウエハの検査を小さい作業スペースで並行して行うために、例えば図 12 に示す各構成部品からなる検査ユニットの複数が積み重ねられてなるウエハ検査装置が提案されており、このようなウエハ検査装置においては、各検査ユニットの高さ方向の寸法が大きいと、ウエハ検査装置全体が相当に巨大なものとなるため、各検査ユニットの高さ方向の寸法を小さくすることは、装置の小型化を図るうえで極めて重要である。

また、接続ピン 86 として、その長さが相当に大きいものが必要であることから、信号伝送系の距離が相当に長くなるため、高速処理が必要とされる高機能の集積回路の電氣的検査に対応することが困難である、という問題がある。

#### 【0010】

## 【特許文献1】

特開 2000-147063 号公報

## 【特許文献2】

特開 2000-323535 号公報

## 【0011】

## 【発明が解決しようとする課題】

本発明は、以上のような事情に基づいてなされたものであって、その目的は、ウエハに形成された多数の集積回路の電氣的検査を行うウエハ検査装置において、装置全体の小型化が可能で、検査用回路基板の使用寿命が短くなることなく、多数の被検査電極についての検査を一括して行うことができ、良好な電気特性を有し、高機能の集積回路の電氣的検査を行うことができるウエハ検査装置、およびこのウエハ検査装置に好適に用いることができる異方導電性コネクタを提供することにある。

## 【0012】

## 【課題を解決するための手段】

本発明の異方導電性コネクタは、面方向に沿って互いに離間して配置された厚み方向に伸びる複数の接続用導電部およびこれらの接続用導電部の間に形成された絶縁部よりなる弾性異方導電膜と、この弾性異方導電膜を支持するフレーム板とよりなり、

前記フレーム板は、線熱膨張係数が  $3 \times 10^{-6} \sim 2 \times 10^{-5} \text{K}^{-1}$  の金属材料よりなり、

前記弾性異方導電膜における接続用導電部は、弾性高分子物質中に数平均粒子径が  $20 \sim 80 \mu\text{m}$  の磁性を示す導電性粒子が密に充填されてなり、当該導電性粒子は、表面に厚みが  $20 \text{ nm}$  以上の貴金属よりなる被覆層が形成されてなり、当該接続用導電部のデュロメーター硬さが  $10 \sim 35$  であり、互いに隣接する接続用導電部間における電気抵抗が  $10 \text{ M}\Omega$  以上であることを特徴とする。

## 【0013】

本発明の異方導電性コネクタにおいては、前記フレーム板は、少なくとも一つの厚み方向に伸びる貫通孔を有し、前記弾性異方導電膜は、その接続用導電部

が前記フレーム板の貫通孔内に位置するよう配置されていることが好ましい。

また、前記フレーム板は、それぞれ厚み方向に伸びる複数の貫通孔を有し、前記弾性異方導電膜は、その接続用導電部が前記フレーム板の各貫通孔内に位置するよう配置されていることが好ましい。

#### 【0014】

また、本発明の異方導電性コネクタにおいては、前記接続用導電部を 20 g の荷重で厚み方向に加圧した場合における当該接続用導電部の許容電流値が 1 A 以上であることが好ましい。

また、前記接続用導電部をその歪み率が 20 % となるよう厚み方向に加圧した場合における当該接続用導電部の許容電流値が 1 A 以上であることが好ましい。

また、本発明の異方導電性コネクタにおいては、前記接続用導電部を 20 g の荷重で厚み方向に加圧した状態で測定される当該接続用導電部の厚み方向における電気抵抗が 0.1  $\Omega$  以下であり、温度 80  $^{\circ}\text{C}$  の環境下で、接続用導電部を 20 g の荷重で厚み方向に 15 分間加圧し、次いで、加圧を解除した状態で 5 分間保持するサイクルを 3000 回繰り返した後において、当該接続用導電部を 20 g の荷重で厚み方向に加圧した状態で測定される当該接続用導電部の厚み方向における電気抵抗が 0.1  $\Omega$  以下であることが好ましい。

また、本発明の異方導電性コネクタにおいては、前記接続用導電部を歪み率が 20 % となるよう厚み方向に加圧した状態で測定される当該接続用導電部の厚み方向における電気抵抗が 0.1  $\Omega$  以下であり、温度 80  $^{\circ}\text{C}$  の環境下で、接続用導電部を歪み率が 20 % となるよう厚み方向に加圧した状態で当該接続用導電部に 1 A の電流を 3000 時間印加させた後に測定される当該接続用導電部の厚み方向における電気抵抗が 0.1  $\Omega$  以下であることが好ましい。

#### 【0015】

本発明のウエハ検査装置は、ウエハに形成された多数の集積回路の電氣的検査を行うためのウエハ検査装置であって、

表面に多数の検査用電極を有する検査用回路基板と、

裏面に前記検査用回路基板の検査用電極のパターンに対応するパターンに従って複数の端子電極が形成された接続用回路基板、およびこの接続用回路基板の表

面に設けられた、検査対象であるウエハにおける集積回路の被検査電極に接触される多数の接触子が配置されてなる接触部材を有し、当該接続用回路基板の端子電極の各々が前記検査用回路基板の検査用電極に対向するよう配置されたプローブカードと、

前記検査用回路基板と前記プローブカードにおける接続用回路基板との間に配置され、当該検査用電極の各々と当該端子電極の各々とを電氣的に接続する、上記の構成の異方導電性コネクタとを具えてなることを特徴とする。

#### 【0016】

本発明のウエハ検査装置においては、異方導電性コネクタにおける弾性異方導電膜が検査用回路基板と接続用回路基板とによって挟圧された状態で、当該検査用回路基板、当該異方導電性コネクタおよび当該接続用回路基板の三者が固定されており、これにより、当該検査用回路基板における検査用電極の各々と当該接続用回路基板における端子電極の各々が当該異方導電性コネクタにおける接続用導電部を介して電氣的に接続されていてもよい。

#### 【0017】

また、本発明のウエハ検査装置においては、検査用回路基板を加圧することによって、プローブカードにおける接触部材の接触子の各々を検査対象であるウエハにおける被検査電極の各々に電氣的に接続するための加圧機構を具えてなり、

当該加圧機構によって検査用回路基板が加圧されることにより、当該検査用回路基板と接続用回路基板とによって異方導電性コネクタにおける弾性異方導電膜が挟圧され、これにより、当該検査用回路基板における検査用電極の各々と当該接続用回路基板における端子電極の各々が当該異方導電性コネクタにおける接続用導電部を介して電氣的に接続されるものであってもよい。

#### 【0018】

##### 【作用】

本発明の異方導電性コネクタによれば、弾性異方導電膜が金属材料よりなるフレーム板によって支持されているため、当該フレーム板を保持したときには異方導電性コネクタ全体が大きく変形することがなく、これにより、当該異方導

電性コネクタの接続対象電極に対する位置合わせ作業を容易に行うことができる。

また、フレーム板を構成する金属材料は線熱膨張係数が小さいものであるため、温度環境の変化に対しても優れた寸法安定性を有し、これにより、良好な電氣的接続状態を安定に維持することができる。

また、弾性異方導電膜における接続用導電部には、デュロメータ硬さが特定の範囲にある弾性高分子物質中に特定の導電性粒子が充填されてなるため、高い導電性が得られると共に、接続対象電極に対する安定な電氣的接続状態が得られる。

また、接続用導電部間における電気抵抗が $10\text{ M}\Omega$ 以上であるため、接続対象電極に対して高い接続信頼性が得られる。

従って、本発明の異方導電性コネクタは、ウエハ検査装置に好適に用いることができる。

#### 【0019】

本発明のウエハ検査装置によれば、検査用回路基板と接続用回路基板とを電氣的に接続するためのコネクタが、前記異方導電性コネクタであることにより、検査用回路基板の検査用電極と接続用回路基板の端子電極との電氣的接続が小さい加圧力で確実に達成されるため、加圧機構として大型のものをを用いることが不要となる。また、検査用回路基板と接続用回路基板との離間距離が短いため、当該ウエハ検査装置の高さ方向の寸法を小さくすることができる。従って、ウエハ検査装置全体の小型化を図ることができる。

#### 【0020】

また、検査用回路基板の検査用電極に作用される加圧力が小さいため、当該検査用電極が損傷することがなく、当該検査用回路基板の使用寿命が短くなることはない。

また、検査用回路基板の検査用電極は、特定の異方導電性コネクタによって電氣的に接続されることにより、当該検査用電極を高密度で配置することができる。従って、多数の検査用電極を形成することができるので、多数の被検査電極についての検査を一括して行うことができる。

また、特定の異方導電性コネクタによる電氣的接続は接触抵抗が小さく、しかも、安定した接続状態を達成することができるため、良好な電気特性が得られる。

また、検査用回路基板の検査用電極と接続用回路基板の端子電極とが特定の異方導電性コネクタを介して電氣的に接続されているため、信号伝送系の距離が短く、従って、高速処理が必要とされる高機能の集積回路の電氣的検査についても対応することができる。

### 【 0 0 2 1 】

#### 【発明の実施の形態】

以下、本発明の実施の形態について詳細に説明する。

#### 〔異方導電性コネクタ〕

図 1 は、本発明に係る異方導電性コネクタの一例を示す平面図であり、図 2 は、図 1 に示す異方導電性コネクタの X-X 断面図である。

この異方導電性コネクタ 1 0 は、厚み方向に導電性を示す弾性異方導電膜 1 5 と、この弾性異方導電膜 1 5 を支持する金属材料よりなる矩形のフレーム板 2 0 とにより構成されている。

図 3 に示すように、フレーム板 2 0 には、それぞれ厚み方向に伸びる断面が矩形の複数の貫通孔 2 1 が縦横に並ぶよう形成されている。また、図示の例では、フレーム板 2 0 の周縁部には、当該異方導電性コネクタ 1 0 を位置合わせして配置するための複数の位置決め用孔 K が形成されている。

弾性異方導電膜 1 5 においては、それぞれ厚み方向に伸びる複数の接続用導電部 1 6 が、接続対象電極のパターンに対応するパターンに従って面方向に互いに離間して配置されている。具体的には、それぞれ同一のパターンの格子点位置に従って複数の接続用導電部 1 6 が配置されてなる複数の接続用導電部群が縦横に並ぶよう配置されている。また、この例では、各接続用導電部群が配置された位置以外の位置に、それぞれ厚み方向に伸びる複数の非接続用導電部 1 8 が、接続用導電部群の各々を取り囲むよう、接続用導電部 1 6 と同一のピッチで面方向に互いに離間して配置されている。これらの接続用導電部 1 6 および非接続用導電部 1 8 の各々は、それらの間に介在された絶縁部 1 7 によって相互に絶縁されて

いる。図4に拡大して示すように、接続用導電部16および非接続用導電部18の各々は、絶縁性の弾性高分子物質中に磁性を示す導電性粒子Pが厚み方向に配向した状態で密に含有されて構成され、絶縁部17は、絶縁性の弾性高分子物質により構成されている。図示の例では、接続用導電部16の各々には、絶縁部17の両面の各々から突出する突出部分16A、16Bが形成されている。

そして、弾性異方導電膜15は、フレーム板20の各貫通孔21内に各接続用導電部群が位置され、かつ、フレーム板20上に非接続用導電部18の各々が位置されるよう、当該フレーム板20に一体的に固定されて支持されている。

#### 【0022】

フレーム板20を構成する金属材料は、線熱膨張係数が $3 \times 10^{-6} \sim 2 \times 10^{-5} \text{K}^{-1}$ のものとされ、好ましくは $3.5 \times 10^{-6} \sim 1.5 \times 10^{-5} \text{K}^{-1}$ のものとされる。

この線熱膨張係数が $2 \times 10^{-5} \text{K}^{-1}$ を超える場合には、後述するウエハ検査装置におけるコネクタとして使用した際に、ウエハを加熱することによって異方導電性コネクタ10の周辺の温度が上昇したときに、当該異方導電性コネクタ10の熱膨張によって接続用導電部16と接続対象電極との位置ずれが生じるため、良好な電氣的接続状態を安定に維持することが困難となる。

#### 【0023】

フレーム板20を構成する金属材料の具体例としては、インバー、スーパーインバー、エリンバー、コパール、42合金、ステンレスなどが挙げられる。

また、フレーム板20の厚みは、 $0.05 \sim 1 \text{mm}$ であることが好ましく、より好ましくは $0.1 \sim 0.8 \text{mm}$ である。この厚みが $0.05 \text{mm}$ 未満である場合には、十分に高い強度を有するフレーム板20が得られない。一方、この厚みが $1 \text{mm}$ を超える場合には、弾性異方導電膜15における接続用導電部16の厚みが相当に大きいものとなって、良好な導電性を有する接続用導電部16を得ることが困難となる。

#### 【0024】

弾性異方導電膜15における接続用導電部16、非接続用導電部18および絶縁部17を構成する弾性高分子物質としては、架橋構造を有するものが好ましい

。かかる架橋弾性高分子物質を得るための硬化性の高分子物質形成材料としては、種々のものを用いることができ、その具体例としては、シリコーンゴム、ポリブタジエンゴム、天然ゴム、ポリイソプレンゴム、スチレンーブタジエン共重合体ゴム、アクリロニトリルーブタジエン共重合体ゴムなどの共役ジエン系ゴムおよびこれらの水素添加物、スチレンーブタジエンージエンブロック共重合体ゴム、スチレンーイソプレンブロック共重合体などのブロック共重合体ゴムおよびこれらの水素添加物、クロロプレン、ウレタンゴム、ポリエステル系ゴム、エピクロルヒドリンゴム、エチレンープロピレン共重合体ゴム、エチレンープロピレンージエン共重合体ゴム、軟質液状エポキシゴムなどが挙げられる。

これらの中では、シリコーンゴムが、成形加工性および電気特性の点で好ましい。

#### 【0025】

シリコーンゴムとしては、液状シリコーンゴムを架橋または縮合したものが好ましい。液状シリコーンゴムは、その粘度が歪速度  $10^{-1} \text{ sec}$  で  $10^5$  ポアズ以下のものが好ましく、縮合型のもの、付加型のもの、ビニル基やヒドロキシル基を含有するものなどのいずれであってもよい。具体的には、ジメチルシリコーン生ゴム、メチルビニルシリコーン生ゴム、メチルフェニルビニルシリコーン生ゴムなどを挙げることができる。

#### 【0026】

これらの中で、ビニル基を含有する液状シリコーンゴム（ビニル基含有ポリジメチルシロキサン）は、通常、ジメチルジクロロシランまたはジメチルジアルコキシシランを、ジメチルビニルクロロシランまたはジメチルビニルアルコキシシランの存在下において、加水分解および縮合反応させ、例えば引続き溶解ー沈殿の繰り返しによる分別を行うことにより得られる。

また、ビニル基を両末端に含有する液状シリコーンゴムは、オクタメチルシクロテトラシロキサンのような環状シロキサンを触媒の存在下においてアニオン重合し、重合停止剤として例えばジメチルジビニルシロキサンを用い、その他の反応条件（例えば、環状シロキサンの量および重合停止剤の量）を適宜選択することにより得られる。ここで、アニオン重合の触媒としては、水酸化テトラメチル

アンモニウムおよび水酸化 *n*-ブチルホスホニウムなどのアルカリまたはこれらのシラノレート溶液などを用いることができ、反応温度は、例えば 80～130℃である。

このようなビニル基含有ポリジメチルシロキサンは、その分子量  $M_w$  (標準ポリスチレン換算重量平均分子量をいう。以下同じ。) が 10000～40000 のものであることが好ましい。また、得られる弾性異方導電膜 15 の耐熱性の観点から、分子量分布指数 (標準ポリスチレン換算重量平均分子量  $M_w$  と標準ポリスチレン換算数平均分子量  $M_n$  との比  $M_w/M_n$  の値をいう。以下同じ。) が 2 以下のものが好ましい。

#### 【0027】

一方、ヒドロキシル基を含有する液状シリコーンゴム (ヒドロキシル基含有ポリジメチルシロキサン) は、通常、ジメチルジクロロシランまたはジメチルジアルコキシシランを、ジメチルヒドロクロロシランまたはジメチルヒドロアルコキシシランの存在下において、加水分解および縮合反応させ、例えば引続き溶解-沈殿の繰り返しによる分別を行うことにより得られる。

また、環状シロキサンを触媒の存在下においてアニオン重合し、重合停止剤として、例えばジメチルヒドロクロロシラン、メチルジヒドロクロロシランまたはジメチルヒドロアルコキシシランなどを用い、その他の反応条件 (例えば、環状シロキサンの量および重合停止剤の量) を適宜選択することによっても得られる。ここで、アニオン重合の触媒としては、水酸化テトラメチルアンモニウムおよび水酸化 *n*-ブチルホスホニウムなどのアルカリまたはこれらのシラノレート溶液などを用いることができ、反応温度は、例えば 80～130℃である。

#### 【0028】

このようなヒドロキシル基含有ポリジメチルシロキサンは、その分子量  $M_w$  が 10000～40000 のものであることが好ましい。また、得られる弾性異方導電膜 15 の耐熱性の観点から、分子量分布指数が 2 以下のものが好ましい。

本発明においては、上記のビニル基含有ポリジメチルシロキサンおよびヒドロキシル基含有ポリジメチルシロキサンのいずれか一方を用いることもでき、両者を併用することもできる。

## 【0029】

上記の高分子物質形成材料中には、当該高分子物質形成材料を硬化させるための硬化触媒を含有させることができる。このような硬化触媒としては、有機過酸化物、脂肪酸アゾ化合物、ヒドロシリル化触媒などを用いることができる。

硬化触媒として用いられる有機過酸化物の具体例としては、過酸化ベンゾイル、過酸化ビスジシクロベンゾイル、過酸化ジクミル、過酸化ジターシャリーブチルなどが挙げられる。

硬化触媒として用いられる脂肪酸アゾ化合物の具体例としては、アゾビスイソブチロニトリルなどが挙げられる。

ヒドロシリル化反応の触媒として使用し得るものの具体例としては、塩化白金酸およびその塩、白金-不飽和基含有シロキサンコンプレックス、ビニルシロキサンと白金とのコンプレックス、白金と1, 3-ジビニルテトラメチルジシロキサンとのコンプレックス、トリオルガノホスフィンあるいはホスファイトと白金とのコンプレックス、アセチルアセテート白金キレート、環状ジエンと白金とのコンプレックスなどの公知のものが挙げられる。

硬化触媒の使用量は、高分子物質形成材料の種類、硬化触媒の種類、その他の硬化処理条件を考慮して適宜選択されるが、通常、高分子物質形成材料100質量部に対して3～15質量部である。

## 【0030】

また、高分子物質形成材料中には、必要に応じて、通常のシリカ粉、コロイダルシリカ、エアロゲルシリカ、アルミナなどの無機充填材を含有させることができる。このような無機充填材を含有させることにより、後述する成形材料のチクソトロピー性が確保され、その粘度が高くなり、しかも、導電性粒子の分散安定性が向上すると共に、硬化処理されて得られる弾性異方導電膜15の強度が高くなる。

このような無機充填材の使用量は、特に限定されるものではないが、あまり多量に使用すると、後述する製造方法において、磁場による導電性粒子Pの配向を十分に達成することができなくなるため、好ましくない。

## 【0031】

接続用導電部 16 および非接続用導電部 18 を構成する磁性を示す導電性粒子 P は、磁性を示す芯粒子の表面に貴金属よりなる被覆層が形成されてなるものである。

ここで、芯粒子を構成する材料としては、鉄、ニッケル、コバルトまたはこれらの合金などの強磁性体金属よりなるもの、非磁性金属粒子若しくはガラスビーズなどの無機物質粒子またはポリマー粒子の表面に強磁性体金属のメッキを施したものなどを用いることができる。また、被覆層を構成する貴金属としては、金、銀、白金、パラジウム、ロジウム、イリジウムおよびこれらの合金などを用いることができる。

芯粒子の表面に導電性金属を被覆する手段としては、特に限定されるものではないが、例えば無電解メッキ、置換メッキ、電気メッキ等の湿式法、スパッタリング等の乾式法などにより行うことができる。

#### 【0032】

導電性粒子 P における被覆層の厚みは 20 nm 以上とされ、好ましくは 30 nm 以上、より好ましくは 50 nm 以上である。この被覆層の厚みが 20 nm 以上であれば、当該導電性粒子はその導電性が十分に高いものとなるため、厚み方向に高い導電性を有する接続用導電部が確実に得られる。

ここで、導電性粒子の被覆層の厚みは、下記数式によって算出されるものをいう。

#### 【0033】

##### 【数1】

$$t = [1 / (S_w \cdot \rho)] \times [N / (1 - N)]$$

〔但し、 $t$  は被覆層の厚み (m)、 $S_w$  は芯粒子の BET 比表面積 ( $\text{m}^2 / \text{kg}$ )、 $\rho$  は被覆層を形成する貴金属の比重 ( $\text{kg} / \text{m}^3$ )、 $N$  は被覆層による被覆率 (被覆層の重量 / 導電性粒子の重量) を示す。〕

#### 【0034】

上記の数式は、次のようにして導かれたものである。

(イ) 芯粒子の重量を  $M_p$  (kg) とすると、芯粒子の表面積  $S$  ( $\text{m}^2$ ) は、

$$S = S_w \cdot M_p \quad \cdots \cdots \text{式 (1)}$$

によって求められる。

(ロ) 被覆層の重量を  $m$  (kg) とすると、当該被覆層の体積  $V$  ( $m^3$ ) は、

$$V = m / \rho \quad \cdots \cdots \text{式 (2)}$$

によって求められる。

(ハ) ここで、被覆層の厚みが導電性粒子の表面全体にわたって均一なものであると仮定すると、 $t = V / S$  であり、これに上記式 (1) および式 (2) を代入すると、被覆層の厚み  $t$  は、

$$t = (m / \rho) / (S w \cdot M_p) = m / (S w \cdot \rho \cdot M_p) \quad \cdots \cdots \text{式 (3)}$$

によって求められる。

(ニ) また、被覆層による被覆率  $N$  は、導電性粒子の重量に対する被覆層の重量の比であるから、この被覆率  $N$  は、

$$N = m / (M_p + m) \quad \cdots \cdots \text{式 (4)}$$

によって求められる。

(ホ) この式 (4) の右辺における分子・分母を  $M_p$  で割ると、

$N = (m / M_p) / (1 + m / M_p)$  となり、両辺に  $(1 + m / M_p)$  をかけると、

$$N (1 + m / M_p) = m / M_p、\text{更には、}$$

$$N + N (m / M_p) = m / M_p \text{ となり、} N (m / M_p) \text{ を右辺に移行すると、}$$

$$N = m / M_p - N (m / M_p) = (m / M_p) (1 - N) \text{ となり、両辺を } (1 - N) \text{ で割ると、}$$

$$N / (1 - N) = m / M_p \text{ となり、}$$

従って、芯粒子の重量  $M_p$  は、

$$M_p = m / [N / (1 - N)] = m (1 - N) / N \quad \cdots \cdots \text{式 (5)}$$

によって求められる。

(ヘ) そして、式 (3) に式 (5) を代入すると、

$$\begin{aligned} t &= 1 / [S w \cdot \rho \cdot (1 - N) / N] \\ &= [1 / (S w \cdot \rho)] \times [N / (1 - N)] \end{aligned}$$

が導かれる。

【0035】

また、被覆層の被覆率Nは、2.5～50質量%であることが好ましく、より好ましくは3～30質量%、さらに好ましくは3.5～25質量%、特に好ましくは4～20質量%である。被覆される貴金属が金である場合には、その被覆率は、3～30質量%であることが好ましく、より好ましくは3.5～25質量%、さらに好ましくは4～20質量%、特に好ましくは4.5～10質量%である。

#### 【0036】

また、導電性粒子Pの数平均粒子径は、20～80 $\mu\text{m}$ とされ、好ましくは30～60 $\mu\text{m}$ 、より好ましくは35～50 $\mu\text{m}$ とされる。

導電性粒子Pの数平均粒子径が20 $\mu\text{m}$ 未満である場合には、接続用導電部に形成される導電路において、導電性粒子同士の接点数が多いため、導電性粒子間の接触抵抗の総和が相当に大きくなる結果、厚み方向に高い導電性が得られない。一方、導電性粒子Pの数平均粒子径が80 $\mu\text{m}$ を超える場合には、接続用導電部に含有される導電性粒子の数が少ないため、接続用導電部間において導電性のバラツキが生じやすく、また、接続用導電部の硬度が高くなりやすく、接続対象電極に対する安定な電氣的接続が得られない。

#### 【0037】

また、導電性粒子Pの含水率は、5%以下であることが好ましく、より好ましくは3%以下、さらに好ましくは2%以下、とくに好ましくは1%以下である。このような条件を満足する導電性粒子Pを用いることにより、後述する製造方法において、成形材料層を硬化処理する際に、当該成形材料層内に気泡が生ずることが防止または抑制される。

#### 【0038】

また、導電性粒子Pの表面がシランカップリング剤などのカップリング剤で処理されたものを適宜用いることができる。導電性粒子の表面がカップリング剤で処理されることにより、当該導電性粒子Pと弾性高分子物質との接着性が高くなり、その結果、得られる接続用導電部16は、繰り返しの使用における耐久性が高いものとなる。

カップリング剤の使用量は、導電性粒子Pの導電性に影響を与えない範囲で適

宜選択されるが、導電性粒子 P の表面におけるカップリング剤の被覆率（導電性芯粒子の表面積に対するカップリング剤の被覆面積の割合）が 5 % 以上となる量であることが好ましく、より好ましくは上記被覆率が 7 ~ 100 %、さらに好ましくは 10 ~ 100 %、特に好ましくは 20 ~ 100 % となる量である。

#### 【0039】

このような導電性粒子 P は、接続用導電部 16 において体積分率で 15 ~ 50 %、好ましくは 20 ~ 40 % となる割合で含有されていることが好ましい。この割合が 15 % 未満の場合には、十分に電気抵抗値の小さい接続用導電部 16 が得られないことがある。一方、この割合が 50 % を超える場合には、得られる接続用導電部は脆弱なものとなりやすく、接続用導電部として必要な弾性が得られないことがある。

#### 【0040】

接続用導電部 16 の各々は、そのデュロメーター硬さが 10 ~ 35 とされ、好ましくは 20 ~ 30 とされる。このデュロメーター硬さが 10 未満である場合には、接続用導電部 16 を加圧した状態で高温環境下に長時間保持すると、当該接続用導電部 16 に大きな永久歪みが生じるため、良好な電氣的接続状態を維持することが困難となる。一方、このデュロメーター硬さが 35 を超える場合には、小さい加圧力では、接続用導電部 16 が十分に変形しないため、当該接続用導電部に電気抵抗の小さい導電路が形成されず、その結果、安定な電氣的接続状態を達成することが困難となる。

本発明において、「デュロメーター硬さ」とは、JIS K6253 のデュロメーター硬さ試験に基づいて、タイプ A デュロメーターによって測定されたものをいう。

#### 【0041】

また、互いに隣接する接続用導電部 16 間における電気抵抗が 10 M $\Omega$  以上とされ、好ましくは 20 M $\Omega$  以上とされる。この電気抵抗が 10 M $\Omega$  未満である場合には、接続対象電極に対する接続信頼性が低いものとなる。

#### 【0042】

また、接続用導電部 16 を 20 g の荷重で厚み方向に加圧した場合における当

該接続用導電部 16 の許容電流値が 1 A 以上であることが好ましい。

また、接続用導電部 16 をその歪み率が 20 % となるよう厚み方向に加圧した場合における当該接続用導電部 16 の許容電流値が 1 A 以上であることが好ましい。

ここで、接続用導電部の許容電流値とは、室温環境下に、接続用導電部を厚み方向に加圧した状態において、当該接続用導電部に 20 秒間電流を印加した後に、当該接続用導電部における電気抵抗が 0.1  $\Omega$  を超えない最大の電流値をいう。

上記の許容電流値が過小である場合には、当該異方導電性コネクタ 10 を例えばウエハの電氣的検査に用いる場合において、当該検査に必要な値の電流を印加させたときに、接続用導電部 16 が発熱して早期に故障しやすくなり、長い使用寿命が得られない。そのため、故障した異方導電性コネクタ 10 を新たなものに交換する作業を頻繁に行わなければならない、検査効率の低下を招く。

#### 【0043】

本発明の異方導電性コネクタにおいては、接続用導電部を 20 g の荷重で厚み方向に加圧した状態で測定される当該接続用導電部の厚み方向における電気抵抗（以下、「電気抵抗  $R_a$  」ともいう。）が 0.1  $\Omega$  以下であることが好ましく、より好ましくは 0.08  $\Omega$  以下である。

この電気抵抗  $R_a$  が 0.1  $\Omega$  を超える場合には、当該異方導電性コネクタ 10 を例えばウエハの電氣的検査に用いる場合において、当該検査に必要な値の電流を印加させたときに、接続用導電部 16 が発熱して損傷しやすくなり、長い使用寿命が得られない。そのため、故障した異方導電性コネクタ 10 を新たなものに交換する作業を頻繁に行わなければならない、検査効率の低下を招く。

#### 【0044】

また、温度 80  $^{\circ}\text{C}$  の環境下で、接続用導電部を 20 g の荷重で厚み方向に 15 分間加圧し、次いで、加圧を解除した状態で 5 分間保持するサイクルを 3000 回繰り返した後において、当該接続用導電部を 20 g の荷重で厚み方向に加圧した状態で測定される当該接続用導電部の厚み方向における電気抵抗（以下、「電気抵抗  $R_b$  」ともいう。）が 0.1  $\Omega$  以下であることが好ましく、より好ましく

は  $0.08\ \Omega$  以下である。

この電気抵抗  $R_b$  が  $0.1\ \Omega$  を超える場合には、当該異方導電性コネクタ 10 を例えばウエハの電氣的検査に用いる場合において、当該検査に必要な値の電流を印加させたときに、接続用導電部 16 が発熱して損傷しやすくなり、長い使用寿命が得られない。そのため、故障した異方導電性コネクタ 10 を新たなものに交換する作業を頻繁に行わなければならない、検査効率の低下を招く。

#### 【0045】

また、接続用導電部を歪み率が 20 % となるよう厚み方向に加圧した状態で測定される当該接続用導電部の厚み方向における電気抵抗（以下、「電気抵抗  $R_c$  」ともいう。）が  $0.1\ \Omega$  以下であることが好ましく、より好ましくは  $0.08\ \Omega$  以下である。

この電気抵抗  $R_c$  が  $0.1\ \Omega$  を超える場合には、当該異方導電性コネクタ 10 を例えばウエハの電氣的検査に用いる場合において、当該検査に必要な値の電流を印加させたときに、接続用導電部 16 が発熱して損傷しやすくなり、長い使用寿命が得られない。そのため、故障した異方導電性コネクタ 10 を新たなものに交換する作業を頻繁に行わなければならない、検査効率の低下を招く。

#### 【0046】

また、温度  $80^\circ\text{C}$  の環境下で、接続用導電部を歪み率が 20 % となるよう厚み方向に加圧した状態で当該接続用導電部に 1 A の電流を 3000 時間印加させた後に測定される当該接続用導電部の厚み方向における電気抵抗（以下、「電気抵抗  $R_d$  」ともいう。）が  $0.1\ \Omega$  以下であることが好ましく、より好ましくは  $0.08\ \Omega$  以下である。

この電気抵抗  $R_d$  が  $0.1\ \Omega$  を超える場合には、当該異方導電性コネクタ 10 を例えばウエハの電氣的検査に用いる場合において、当該検査に必要な値の電流を印加させたときに、接続用導電部 16 が発熱して損傷しやすくなり、長い使用寿命が得られない。そのため、故障した異方導電性コネクタ 10 を新たなものに交換する作業を頻繁に行わなければならない、検査効率の低下を招く。

#### 【0047】

また、上記の電気抵抗  $R_a$ 、電気抵抗  $R_b$ 、電気抵抗  $R_c$  および電気抵抗  $R_d$

の各々は、当該異方導電性コネクタ 10 の全ての接続用導電部についての変動係数が 50 % 以下であることが好ましい。この変動係数が 50 % を超える場合には、当該異方導電性コネクタは、接続用導電部間における導電性のバラツキが大きいものとなるため、高い接続信頼性が得られないことがある。

#### 【0048】

弾性異方導電膜 15 の全厚（図示の例では接続用導電部 16 における厚み）は、0.2～1.5 mm であることが好ましく、より好ましくは 0.3～1.0 mm である。この厚みが 0.2 mm 以上であれば、十分な強度を有する弾性異方導電膜 15 が確実に得られる。一方、この厚みが 1.5 mm 以下であれば、所要の導電性を有する接続用導電部 16 が確実に得られる。

接続用導電部 16 における突出部分 35A, 35B の突出高さは、その合計が当該接続用導電部 16 の厚みの 20 % 以上であることが好ましく、より好ましくは 25 % 以上である。このような突出高さを有する突出部分 35A, 35B を形成することより、当該接続用導電部 16 が小さい圧力で十分に圧縮されるため、良好な導電性が確実に得られる。

#### 【0049】

このような異方導電性コネクタ 10 は、例えば以下のようにして製造することができる。

まず、図 3 に示すフレーム板 20 を作製する。ここで、フレーム板 20 の貫通孔 21 を形成する方法としては、打ち抜き型を用いる方法、パンチング加工法、ドリル加工法、ルーター加工法、レーザー加工法等の物理的な加工方法、化学エッチング法などの化学的な加工方法などを利用することができる。

次いで、硬化処理によって絶縁性の弾性高分子物質となる液状の高分子物質形成材料中に、磁性を示す導電性粒子が分散されてなる流動性の成形材料を調製する。そして、図 5 に示すように、弾性異方導電膜成形用の金型 50 を用意し、この金型 50 における下型 56 の上面にスペーサー（図示省略）を介してフレーム板 20 を位置合わせして配置し、このフレーム板 20 上にスペーサー（図示省略）を介して上型 51 を位置合わせして配置すると共に、上型 51、下型 56、スペーサーおよびフレーム板 20 によって形成される成形空間内に、調製した成形

材料を充填して成形材料層 15A を形成する。

#### 【0050】

ここで、金型 50 について説明すると、上型 51 においては、強磁性体基板 52 の下面に、非磁性体基板 53 が例えばネジ機構（図示省略）によって固定されて配置されている。この非磁性体基板 53 の上面には、形成すべき弾性異方導電膜 15 の接続用導電部 16 および非接続用導電部 18 の配置パターンに対掌なパターンに従って、後述する磁性部材 54A が収容される多数の磁性部材収容用凹所 53A が形成され、非磁性体基板 53 の下面には、形成すべき弾性異方導電膜 15 の接続用導電部 16 の配置パターンに対掌なパターンに従って、当該接続用導電部 16 の突出部分 16A を形成するための突出部分形成用凹所 53B が形成されている。そして、非磁性体基板 53 の磁性部材収容用凹所 53A 内には、当該磁性部材収容用凹所 53A の径に適合する径を有する球状の磁性部材 54A が収容され、更に、磁性部材 54A を磁性部材収容用凹所 53A 内に固定するための柱状の蓋材 54B が、当該磁性部材収容用凹所 53A の開口を塞ぐよう設けられている。

#### 【0051】

一方、下型 56 においては、強磁性体基板 57 の上面に、非磁性体基板 58 が例えばネジ機構（図示省略）によって固定されて配置されている。この非磁性体基板 58 の下面には、形成すべき弾性異方導電膜 15 の接続用導電部 16 および非接続用導電部 18 の配置パターンと同一のパターンに従って、磁性部材 59A が収容される多数の磁性部材収容用凹所 58A が形成され、非磁性体基板 58 の上面には、形成すべき弾性異方導電膜 15 の接続用導電部 16 の配置パターンと同一のパターンに従って、当該接続用導電部 16 の突出部分 16B を形成するための突出部分形成用凹所 58B が形成されている。そして、非磁性体基板 58 の磁性部材収容用凹所 58A 内には、当該磁性部材収容用凹所 58A の径に適合する径を有する球状の磁性部材 59A が収容され、更に、磁性部材 59A を磁性部材収容用凹所 58A 内に固定するための柱状の蓋材 59B が、当該磁性部材収容用凹所 58A の開口を塞ぐよう設けられている。

#### 【0052】

上型 51 および下型 56 の各々における強磁性体基板 52, 57 および磁性部材 54A, 59A を構成する材料としては、鉄、ニッケル、コバルトまたはこれらの合金などを用いることができる。

また、上型 51 および下型 56 の各々における非磁性体基板 53, 58 を構成する材料としては、銅、真鍮等の銅合金、アルミニウム、ジュラルミン等のアルミニウム合金などを用いることができる。

また、蓋材 54B, 59B を構成する材料としては、強磁性体材料を用いることが好ましく、その具体例としては、鉄、ニッケル、コバルトまたはこれらの合金などを挙げることができる。

#### 【0053】

次いで、上型 51 における強磁性体基板 52 の上面および下型 56 における強磁性体基板 57 の下面に、電磁石または永久磁石を配置し、強度分布を有する平行磁場、すなわち上型 51 の磁性部材 54A とこれに対応する下型 56 の磁性部材 59A との間において大きい強度を有する平行磁場を成形材料層 15A の厚み方向に作用させる。その結果、成形材料層 15A においては、図 6 に示すように、当該成形材料層 15A 中に分散されている導電性粒子 P が、上型 51 の磁性部材 54A とこれに対応する下型 56 の磁性部材 59A との間に位置する部分に集合すると共に、厚み方向に並ぶよう配向する。

そして、この状態において、成形材料層 15A を硬化処理することにより、上型 51 の磁性部材 54A とこれに対応する下型 56 の磁性部材 59A との間に配置された導電性粒子 P が密に含有された接続用導電部 16 および非接続用導電部 18 と、これらの接続用導電部 16 および非接続用導電部 18 の間に介在された、導電性粒子 P が全くあるいは殆ど存在しない絶縁部 17 とよりなる異方導電膜 15 が、フレーム板 20 に固定支持された状態で形成され、以て、異方導電性コネクタ 10 が製造される。

#### 【0054】

以上において、成形材料層 15A に作用される平行磁場の強度は、上型 51 の磁性部材 54A とこれに対応する下型 56 の磁性部材 59A との間において平均で 0.02 ~ 2.0 T となる大きさが好ましい。

成形材料層 15A の硬化処理は、平行磁場を作用させたままの状態で行うこともできるが、平行磁場の作用を停止させた後に行うこともできる。

成形材料層 15A の硬化処理は、使用される材料によって適宜選定されるが、通常、加熱処理によって行われる。具体的な加熱温度および加熱時間は、成形材料層 15A を構成する高分子物質用材料などの種類、導電性粒子 P の移動に要する時間などを考慮して適宜設定される。

#### 【0055】

弾性異方導電膜 15 を成形するための金型としては、図 5 に示す金型 50 の代わりに図 7 に示す金型 60 を用いることができる。

この金型 60 について具体的に説明すると、この金型 60 は、上型 61 および下型 66 が互いに対向するよう配置されて構成されている。

上型 61 においては、強磁性体基板 62 の下面に、目的とする弾性異方導電膜 15 の接続用導電部 16 および非接続用導電部 18 の配置パターンに対掌なパターンに従って強磁性体層 63 が形成され、この強磁性体層 63 以外の個所には、当該強磁性体層 63 の厚みより大きい厚みを有する非磁性体層 64 が形成されている。

一方、下型 66 においては、強磁性体基板 67 の上面に、目的とする弾性異方導電膜 15 の接続用導電部 16 および非接続用導電部 18 の配置パターンと同一のパターンに従って強磁性体層 68 が形成され、この強磁性体層 68 以外の個所には、当該強磁性体層 68 の厚みより大きい厚みを有する非磁性体層 69 が形成されている。

上型 61 および下型 66 の各々における強磁性体基板 62, 67 および強磁性体層 63, 68 を構成する材料としては、鉄、ニッケル、コバルトまたはこれらの合金などを用いることができる。

また、上型 61 および下型 66 の各々における非磁性体部分 64, 69 を構成する材料としては、銅などの非磁性金属、ポリイミドなどの耐熱性樹脂、放射線硬化性樹脂などを用いることができる。

#### 【0056】

上記のような異方導電性コネクタ 10 によれば、弾性異方導電膜 15 が金属

材料よりなるフレーム板 20 によって支持されているため、当該フレーム板 20 を保持したときには異方導電性コネクタ 10 全体が大きく変形することがなく、これにより、当該異方導電性コネクタ 10 の接続対象電極に対する位置合わせ作業を容易に行うことができる。

また、フレーム板 20 を構成する金属材料は線熱膨張係数が小さいものであるため、温度環境の変化に対しても優れた寸法安定性を有し、これにより、良好な電氣的接続状態を安定に維持することができる。

また、弾性異方導電膜 15 における接続用導電部 16 には、特定の導電性粒子 P が充填されており、しかも、当該接続用導電部 16 を構成する弾性高分子物質のデュロメータ硬さが特定の範囲にあるため、高い導電性が得られると共に、接続対象電極に対する安定な電氣的接続状態が得られる。

また、接続用導電部 16 間における電気抵抗が  $10\text{ M}\Omega$  以上であるため、接続対象電極に対して高い接続信頼性が得られる。

#### 【0057】

##### 〔ウエハ検査装置〕

図 8 は、本発明に係るウエハ検査装置の一例における構成を示す説明用断面図であって、このウエハ検査装置は、多数の集積回路が形成されたウエハについて WLB I 試験またはプローブ試験を行うためのものである。

このウエハ検査装置は、表面（図において下面）に多数の検査用電極 31 が形成された検査用回路基板 30 を有し、この検査用回路基板 30 の表面には、図 1 および図 2 に示す異方導電性コネクタ 10 を介してプローブカード 40 が配置されている。また、検査用回路基板 30 の上方には、当該検査用回路基板を下方に加圧する加圧機構 35 が設けられている。

プローブカード 40 は、接続用回路基板 41 と、この接続用回路基板 41 の表面（図において下面）に設けられた、検査対象であるウエハ 1 における集積回路の被検査電極（図示省略）に接触される多数の接触子（図示省略）を有する接触部材 45 とにより構成されている。接触部材 45 の下方には、検査対象であるウエハ 1 が載置される、加熱板を兼ねたウエハトレイ 36 が配置されている。

#### 【0058】

図 9 にも拡大して示すように、プローブカード 40 における接続用回路基板 41 の裏面には、検査用回路基板 30 の検査用電極 31 のパターンに対応するパターンに従って多数の端子電極 42 が形成されており、当該接続用回路基板 41 は、ガイドピン 43 によって、端子電極 42 の各々が検査用回路基板 30 の検査用電極 31 に対向するよう位置決めされた状態で配置されている。

異方導電性コネクタ 10 における弾性異方導電膜 15 には、検査用回路基板 30 の検査用電極 31 のパターンに対応するパターンに従って複数の接続用導電部 16 が形成されている。そして、異方導電性コネクタ 10 は、ガイドピン 43 によって、弾性異方導電膜 15 における接続用導電部 16 の各々が、検査用回路基板 30 の検査用電極 31 と接続用回路基板 41 の端子電極 42 との間に位置するよう位置決めされた状態で配置されている。

#### 【0059】

そして、この例のウエハ検査装置においては、異方導電性コネクタ 10 における弾性異方導電膜 15 が検査用回路基板 30 と接続用回路基板 41 とによって挟圧された状態で、当該検査用回路基板 30、当該異方導電性コネクタ 10 および当該接続用回路基板 41 の三者が固定されており、これにより、当該検査用回路基板 30 における検査用電極 31 の各々と当該接続用回路基板 41 における端子電極 42 の各々とが当該異方導電性コネクタ 10 における接続用導電部 16 を介して電氣的に接続されている。

ここで、異方導電性コネクタ 10 における弾性異方導電膜 15 は、当該弾性異方導電膜 15 の接続用導電部 16 の電気抵抗値が  $0.1\ \Omega$  以下となる状態に挟圧されることが好ましく、具体的には、検査用回路基板 30 と接続用回路基板 41 とよる弾性異方導電膜 15 に対する挟圧力が、接続用導電部 16 の 1 個当たり  $0.03 \sim 0.4\ \text{N}$  となる力であることが好ましい。この値が過小である場合には、接続用導電部 16 の電気抵抗値にばらつきが生じやすくなり、また、接続用導電部 16 の電気抵抗値が高くなって所要の電氣的検査を行うことが困難となることがある。一方、この値が過大である場合には、検査用回路基板 30 および接続用回路基板 41 が変形するため、安定な電氣的接続が困難となることがある。

また、弾性異方導電膜 15 に対する挟圧力を調整するため、検査用回路基板 3

0 と接続用回路基板 41 との間にスペーサーを設けることができる。

また、検査用回路基板 30、異方導電性コネクタ 10 および接続用回路基板 41 を固定する手段としては、螺子による手段、ガイドピン 43 としてボルトを用いてナットにより固定する手段などが挙げられる。

#### 【0060】

検査用回路基板 30 における検査用電極 31 のピッチは、0.5～5mm であることが好ましく、より好ましくは 1～2mm である。このようなピッチで検査用電極 31 が形成されることにより、当該検査用電極 31 と接続用回路基板 41 の端子電極 42 との所要の電氣的接続を確実に達成することができると共に、検査用電極 31 を高い密度で配置することが可能であるため、検査対象であるウエハ 1 の被検査電極数に応じた多数の検査用電極 31 を形成することができる。

#### 【0061】

プローブカード 40 における接触部材 45 の接触子の各々は、接続用回路基板 41 における回路を介して検査用回路基板 30 の検査用電極 31 の各々に電氣的に接続されている。

接触部材 45 の具体的な構成は、特に限定されるものではなく、例えばブレードまたはピンおよびマイクロスプリングピンよりなる接触子が配列されてなるもの、接触子が異方導電性シートよりなるもの、絶縁性シートにその厚み方向に貫通して伸びる金属体よりなる接触子が配置されてなるシート状コネクタよりなるもの、異方導電性シートとシート状コネクタが積層されてなるものなどを採用することができる。

#### 【0062】

上記のウエハ検査装置においては、検査対象であるウエハ 1 がウエハトレイ 36 上に載置され、当該検査用回路基板 30 が加圧機構 36 によって下方に加圧されることにより、ウエハ 1 に形成された一部の集積回路の被検査電極の各々に、接触部材 45 の接触子の各々が接触し、これにより、所要の電氣的接続が達成される。そして、ウエハトレイ 36 によってウエハ 1 が所定の温度に加熱され、この状態で、ウエハ 1 についての所要の電氣的検査（WLB I 試験またはプローブ試験）が行われる。

以上において、加圧機構 36 による加圧力は、ウエハ 1 に対する接触部材 45 の安定な電氣的接続が得られる範囲で選択される。

#### 【0063】

このようなウエハ検査装置によれば、検査用回路基板 30 と接続用回路基板 41 とを電氣的に接続するためのコネクタが、図 1 および図 2 に示す異方導電性コネクタ 10 であることにより、検査用回路基板 30 の検査用電極 31 と接続用回路基板 41 の端子電極 42 との電氣的接続が小さい加圧力で確実に達成されるため、これらの加圧手段として大型のものをを用いることが不要となる。また、検査用回路基板 30 と接続用回路基板 41 との離間距離が短いため、当該ウエハ検査装置の高さ方向の寸法を小さくすることができる。従って、ウエハ検査装置全体の小型化を図ることができる。

また、検査用回路基板 30 の検査用電極 31 に作用される加圧力が小さいため、当該検査用電極 31 が損傷することがなく、当該検査用回路基板 30 の使用寿命が短くなることはない。

また、検査用回路基板 30 の検査用電極 31 は、特定の異方導電性コネクタ 10 によって電氣的に接続されることにより、当該検査用電極 31 を高密度で配置することができ、従って、多数の検査用電極 31 を形成することができるので、多数の被検査電極についての検査を一括して行うことができる。

#### 【0064】

また、異方導電性コネクタ 10 による電氣的接続は接触抵抗が小さく、しかも、安定した接続状態を達成することができるため、良好な電気特性が得られる。

また、検査用回路基板 30 の検査用電極 31 と接続用回路基板 41 の端子電極 42 とが異方導電性コネクタ 10 を介して電氣的に接続されているため、信号伝送系の距離が短く、従って、高速処理が必要とされる高機能の集積回路の電氣的検査についても対応することができる。

また、異方導電性コネクタ 10 におけるフレーム板 20 は線熱膨張係数が小さい材料よりなるため、温度環境の変化に対しても検査用回路基板 30 と接続用回路基板 41 との良好な電氣的接続状態を安定に維持することができる。

また、異方導電性コネクタ 10 の弾性異方導電膜 15 における接続用導電部 16 には、特定の導電性粒子 P が充填されており、しかも、当該接続用導電部 16 のデュロメータ硬さが特定の範囲にあるため、高い導電性が得られると共に、検査用回路基板 30 および接続用回路基板 41 に対する安定な電氣的接続状態が得られる。

また、接続用導電部 16 間における電気抵抗が  $10\text{ M}\Omega$  以上であるため、検査用回路基板 30 および接続用回路基板 41 に対して高い接続信頼性が得られる。

#### 【0065】

本発明においては、上記の例に限定されず種々の変更を加えることが可能である。

例えば異方導電性コネクタ 10 において、弾性異方導電膜 15 における非接続用導電部 18 は必須のものではない。

また、フレーム板 20 の貫通孔 21 毎に、互いに独立した複数の弾性異方導電膜が形成されていてもよい。

また、フレーム板 20 は、単一の貫通孔が形成されてなる枠状のものであってもよい。

#### 【0066】

また、検査用回路基板 30、異方導電性コネクタ 10 および接続用回路基板 41 の三者を固定することは必須ではない。具体的には、非検査状態においては、異方導電性コネクタ 10 における弾性異方導電膜 15 を無加圧状態とし、加圧機構 36 によって検査用回路基板 30 が加圧されることにより、当該検査用回路基板 30 と接続用回路基板 41 とによって異方導電性コネクタ 10 における弾性異方導電膜 15 が挟圧され、これにより、当該検査用回路基板 30 における検査用電極 31 の各々と当該接続用回路基板 41 における端子電極 42 の各々が当該異方導電性コネクタ 10 における接続用導電部 16 を介して電氣的に接続される構成であってもよい。

このようなウエハ検査装置においては、検査用回路基板 30 が加圧機構 36 によって下方に加圧されることにより、異方導電性コネクタ 10 における接続用導電部 16 の各々が厚み方向に加圧され、これにより、検査用回路基板 30 の検

査用電極 31 の各々と接続用回路基板 41 の端子電極 42 の各々とが電氣的に接続されると共に、ウエハ 1 に形成された一部の集積回路の被検査電極の各々に、接触部材 45 の接触子の各々が接触し、これにより、所要の電氣的接続が達成される。そして、ウエハトレイ 36 によってウエハ 1 が所定の温度に加熱され、この状態で、ウエハ 1 についての所要の電氣的検査（WLB I 試験またはプローブ試験）が行われる。

#### 【0067】

##### 【実施例】

以下、本発明の具体的な実施例について説明するが、本発明はこれらに限定されるものではない。

#### 【0068】

##### 〔金型の作製例 1〕

厚みが 3.0 mm の真鍮板を用意し、ドリリング装置によって、非磁性体基板の一面に、径が 0.3 mm で深さ 2.7 mm の断面円形の複数の磁性部材収容用凹所を X-X 方向（図 1 に示す X-X 方向に対応する方向を意味する。以下同じ。）において 0.8 mm、Y-Y 方向（X-X 方向に直交する方向を意味する。以下同じ。）において 0.8 mm のピッチで形成すると共に、非磁性体基板の他面に、径が 0.3 mm で深さが 0.05 mm の断面円形の複数の突出部分形成用凹所を X-X 方向において 0.8 mm、Y-Y 方向において 0.8 mm のピッチで形成することにより、非磁性体基板を作製した。この非磁性体基板における各磁性部材収容用凹所内に、鉄よりなる直径が 0.3 mm の球状の磁性部材を配置し、更に、厚み 2.4 mm で径が 0.3 mm の円柱状の蓋材を、磁性部材収容用凹所の各々における開口を塞ぐよう配置した。

そして、この非磁性体基板を、厚みが 6 mm の鉄よりなる強磁性体基板上に配置し、ネジ機構によって固定することにより、上型を作製すると共に、この上型と同様にして下型を作製し、以て図 5 に示す構成の金型を製造した。この金型を「金型 a」とする。

#### 【0069】

##### 〔金型の作製例 2〕

厚みが 6 mm の鉄板を用意し、この鉄板の一面に対して、ドライフィルムレジストおよび塩化第二鉄を用いてフォトリソグラフィ処理を施すことにより、厚みが 5.9 mm の鉄よりなる強磁性体基板上に厚みが 0.1 mm で径が 0.25 mm の円板状の複数の強磁性体層が X-X 方向において 0.65 mm、Y-Y 方向に 0.65 mm のピッチで一体に形成されてなる中間体を作製した。

この中間体の一面における強磁性体層以外の領域に、レジストによって厚みが 0.15 mm の非磁性体層を形成することにより、上型を作製すると共に、この上型と同様にして下型を作製し、以て図 7 に示す構成の金型を製造した。この金型を「金型 b」とする。

#### 【0070】

##### 〈実施例 1〉

厚みが 0.15 mm のステンレス (SUS-304、線熱膨張係数:  $1.73 \times 10^{-5} \text{K}^{-1}$ ) よりなり、12.5 mm × 11.5 mm の矩形の貫通孔の 16 個が縦横 (4 個 × 4 個) に並ぶよう形成されてなるフレーム板を作製すると共に、厚みが 0.1 mm のステンレス (SUS-304) よりなり、57 mm × 53 mm の矩形の貫通孔が 1 個形成されてなるスペーサー 2 枚を作製した。

一方、付加型液状シリコーンゴム「X-34-1632」(信越化学工業株式会社製) 12 g に数平均粒子径が  $30 \mu\text{m}$  の導電性粒子 4.5 g を添加して混合することにより、弾性異方導電膜成形用の成形材料を調製した。ここで、導電性粒子としては、ニッケルよりなる芯粒子の表面に厚みが 75 nm の金よりなる被覆層が形成されてなるものを用いた。

#### 【0071】

次いで、金型 a における下型の上面にスペーサーを介してフレーム板を位置合わせして配置し、このフレーム板上にスペーサーを介して上型を位置合わせして配置すると共に、上型、下型、2 枚のスペーサーおよびフレーム板によって形成される成形空間内に、調製した成形材料を充填して成形材料層を形成した。

そして、上型における強磁性体基板の上面および下型における強磁性体基板の下面に、電磁石を配置して作動させることにより、成形材料層に対して、上型の磁性部材とこれに対応する下型の磁性部材との間に 1 テスラの平行磁場を作用さ

せながら、100℃、1.5時間の条件で硬化処理を行うことにより、フレーム板の貫通孔の各々に弾性異方導電膜を形成し、以て異方導電性コネクタを製造した。

#### 【0072】

##### 〈実施例2〉

厚みが0.1mmの42アロイ（線熱膨張係数： $5 \times 10^{-6} \text{K}^{-1}$ ）よりなり、8.5mm×8.5mmの矩形の貫通孔の64個が縦横（縦8個×横8個）に並ぶよう形成されてなるフレーム板を作製すると共に、厚みが0.1mmのリン青銅よりなり、83mm×83mmの矩形の貫通孔が1個形成されてなるスペーサー2枚を作製した。

一方、付加型液状シリコンゴム「KE-2000-20」（信越化学工業株式会社製）16gに数平均粒子径が40μmの導電性粒子8.8gを添加して混合することにより、弾性異方導電膜成形用の成形材料を調製した。ここで、導電性粒子としては、ニッケルよりなる芯粒子の表面に厚みが84nmの金よりなる被覆層が形成されてなるものを用いた。

#### 【0073】

次いで、金型bにおける下型の上面にスペーサーを介してフレーム板を位置合わせして配置し、このフレーム板上にスペーサーを介して上型を位置合わせして配置すると共に、上型、下型、2枚のスペーサーおよびフレーム板によって形成される成形空間内に、調製した成形材料を充填して成形材料層を形成した。

そして、上型における強磁性体基板の上面および下型における強磁性体基板の下面に、電磁石を配置して作動させることにより、成形材料層に対して、上型の磁性部材とこれに対応する下型の磁性部材との間に1テスラの平行磁場を作用させながら、100℃、1.5時間の条件で硬化処理を行うことにより、フレーム板の貫通孔の各々に弾性異方導電膜を形成し、以て異方導電性コネクタを製造した。

#### 【0074】

##### 〈比較例1〉

フレーム板として、厚みが0.1mmのPET〔ポリエチレンテレフタート（

線熱膨張係数： $6 \times 10^{-5} \text{K}^{-1}$ ）よりなり、 $13.0 \text{ mm} \times 12.0 \text{ mm}$ の矩形の貫通孔の16個が縦横（縦4個×横4個）に並ぶよう形成されてなるものを用いたこと以外は実施例1と同様にして異方導電性コネクタを製造した。

得られた異方導電性コネクタは、成形材料層の硬化処理におけるシリコンゴムの硬化収縮によって弾性異方導電膜に歪みが生じた結果、当該異方導電性コネクタに反りが生じてその表面の平面性が保たれておらず、更に弾性異方導電膜の接続用導電部が、所期の位置から位置ずれしており、ウエハ検査装置における検査用回路基板と接続用回路基板との電氣的接続を達成することが困難なものであった。

#### 【0075】

##### 〈比較例2〉

付加型液状シリコンゴム「X-34-1632」（信越化学工業株式会社製）12gに数平均粒子径が $120 \mu\text{m}$ の導電性粒子4.5gを添加して混合することにより、弾性異方導電膜成形用の成形材料を調製した。ここで、導電性粒子としては、ニッケルよりなる芯粒子の表面に厚みが125nmの金よりなる被覆層が形成されてなるものを用いた。

この成形材料を用いたこと以外は実施例1と同様にして異方導電性コネクタを製造した。

#### 【0076】

##### 〈比較例3〉

付加型液状シリコンゴム「KE-2000-60」（信越化学工業株式会社製）12gに数平均粒子径が $30 \mu\text{m}$ の導電性粒子4.5gを添加して混合することにより、弾性異方導電膜成形用の成形材料を調製した。ここで、導電性粒子としては、ニッケルよりなる芯粒子の表面に厚みが75nmの金よりなる被覆層が形成されてなるものを用いた。

この成形材料を用いたこと以外は実施例1と同様にして異方導電性コネクタを製造した。

#### 【0077】

実施例1～2および比較例1～3に係る異方導電性コネクタにおける各部の

寸法、接続用導電部における導電性粒子の割合および接続用導電部のデュロメータ硬さを下記表 1 に示す。

【0078】

【表 1】

		実施例 1	実施例 2	比較例 1	比較例 2	比較例 3
フレーム板	厚み (mm)	0.15	0.1	0.15	0.15	0.15
	貫通孔の寸法	縦 (mm)	8.5	12.5	12.5	12.5
		横 (mm)	8.5	11.5	11.5	11.5
	線熱膨張係数 ( $\times 10^{-5} \text{K}^{-1}$ )	1.73	0.5	6	1.73	1.73
弾性異方導電膜	導電部		0.30	0.25	0.30	0.30
	径 (mm)		0.45	0.40	0.40	0.45
	厚み (mm)		0.05	0.05	0.05	0.05
	突出高さ (mm)		0.05	0.05	0.05	0.05
	ピッチ (mm)		0.8	0.65	0.8	0.8
	導電性粒子		30	40	30	30
	数平均粒子径 ( $\mu\text{m}$ )		75	84	75	75
	被覆層		15	15	15	15
	被覆率 (質量%)		25	30	25	25
	含有割合 (体積%)		33	24	33	63
デュロメータ硬さ		0.35	0.30	0.30	0.35	0.35
絶縁部の厚み (mm)		0.35	0.30	0.30	0.35	0.35

【0079】

〔異方導電性コネクタの評価〕

実施例 1～2 および比較例 2～3 に係る異方導電性コネクタに対して、下記の試験 1 および試験 2 を行い、また、実施例 1～2 および比較例 2 に係る異方導電性コネクタに対して、下記の試験 3 および試験 4 を行った。

## 【0080】

## 試験1：

一面に、それぞれ表面に金メッキを施した複数のパターン電極が弾性異方導電膜の接続用導電部のパターンと同一のパターンに従って形成された一方の試験用電極板と、一面に、それぞれ表面に金メッキを施した複数のパターン電極が弾性異方導電膜の接続用導電部のパターンと対掌なパターンに従って形成された他方の試験用電極板とを用意し、一方の試験用電極板上に異方導電性コネクタをその弾性異方導電膜の接続用導電部の各々が当該一方の試験用電極板のパターン電極上に位置するよう位置合わせした状態で配置し、この異方導電性コネクタにおける弾性異方導電膜上に、他方の試験用電極板をそのパターン電極の各々が接続用導電部上に位置するよう位置合わせして配置した。

次いで、80℃の環境下において、他方の試験用電極板によって異方導電性コネクタにおける弾性異方導電膜をその厚み方向に接続用導電部1個当たりの荷重が20gとなるよう加圧し、この状態で15分間保持した後に、当該接続用導電部における厚み方向の電気抵抗（以下、「導通抵抗」という。）および隣接する接続用導電部間の電気抵抗（以下、「絶縁抵抗」という。）を測定した。この測定が終了した後、他方の試験用電極板による弾性異方導電膜の加圧を解除し、この状態で5分間保持した。この操作を1サイクルとして合計で3000サイクル繰り返した。

1サイクル目における導通抵抗の平均値、最大値、最小値および絶縁抵抗の最小値、並びに3000サイクル目の導通抵抗の平均値、最大値、最小値および絶縁抵抗の最小値を下記表2に示す。

## 【0081】

## 試験2：

図10に示すように、一面における中央領域に、それぞれ金メッキを施した複数のパターン電極101が弾性異方導電膜15の接続用導電部16のパターンと同一のパターンに従って形成され、当該一面における周縁領域に、当該パターン電極101の各々にプリント配線（図示省略）によって電氣的に接続された複数のリード電極102が形成された一方の試験用電極板100と、一面全面に金メ

ッキよりなる共通電極 106 が形成された他方の試験用電極板 105 とを用意し、一方の試験用電極板 100 上に異方導電性コネクタ 10 をその弾性異方導電膜 15 の接続用導電部 16 の各々が当該一方の試験用電極板 100 のパターン電極 101 上に位置するよう位置合わせした状態で配置し、この異方導電性コネクタ 10 における弾性異方導電膜 15 上に、他方の試験用電極板 105 を配置し、一方の試験用電極板 100 における各リード電極 102 および他方の試験用電極板 105 における共通電極 106 を、電圧計 110 に電氣的に接続すると共に、この電圧計 110 とは並列に、定電流制御装置 116 を介して直流電源 115 に電氣的に接続した。

次いで、室温環境下において、他方の試験用電極板 105 によって異方導電性コネクタ 10 における弾性異方導電膜 15 をその厚み方向に接続用導電部 16 の 1 個当たりの荷重が 20 g となるよう加圧し、この状態で、直流電源 115 および定電流制御装置 116 によって弾性異方導電膜 15 の接続用導電部 16 の一つに 1 A の直流電流を 20 秒間印加した後、当該接続用導電部 16 における電圧を電圧計 110 によって測定した。この電圧の測定を全ての接続用導電部 16 に対して順次行った。そして、接続用導電部 16 に印加した直流電流を  $I_1$  ( $= 1$  A) とし、測定した接続用導電部 16 の電圧の値 (V) を  $V_1$  として、下記の数式により、導通抵抗  $R_1$  を求めた。また、上記試験 1 と同様にして弾性異方導電膜 15 の接続用導電部 16 を 3000 回押圧した後、当該弾性異方導電膜 15 の接続用導電部 16 の導通抵抗  $R_1$  を上記と同様にして求めた。この導通抵抗  $R_1$  の値が 100 m $\Omega$  以下のとき、当該接続用導電部 16 の許容電流値が 1 A 以上である。導通抵抗  $R_1$  の平均値を下記表 2 に示す。

【0082】

【数 2】

$$R_1 = V_1 / I_1$$

【0083】

【表2】

	試験 1										試験 2	
	1 サイクル目					3 0 0 0 サイクル目					導通抵抗R <sub>1</sub> (mΩ)	
	導通抵抗				絶縁抵抗 の最小値 (Ω)	導通抵抗				絶縁抵抗 の最小値 (Ω)	初期	3000 回加圧後
	平均値 (mΩ)	最大値 (mΩ)	最小値 (mΩ)	変動係数 (%)		平均値 (mΩ)	最大値 (mΩ)	最小値 (mΩ)	変動係数 (%)			
実施例 1	34	58	23	28	>10M	56	86	42	29	>10M	38	61
実施例 2	38	61	29	31	>10M	63	93	48	33	>10M	41	68
比較例 1	試験 せ ず											
比較例 2	85	126	28	67	>10M	156	328	84	56	>10M	76	175
比較例 3	68	87	46	26	>10M	113	223	73	42	>10M	65	128

【0084】

試験3:

一面に、それぞれ表面に金メッキを施した複数のパターン電極が弾性異方導電膜の接続用導電部のパターンと同一のパターンに従って形成された一方の試験用電極板と、一面に、それぞれ表面に金メッキを施した複数のパターン電極が弾性異方導電膜の接続用導電部のパターンと対掌なパターンに従って形成された他方の試験用電極板とを用意し、一方の試験用電極板上に異方導電性コネクタをその弾性異方導電膜の接続用導電部の各々が当該一方の試験用電極板のパターン電極上に位置するよう位置合わせした状態で配置し、この異方導電性コネクタにおける弾性異方導電膜上に、他方の試験用電極板をそのパターン電極の各々が接続用導電部上に位置するよう位置合わせして配置した。

次いで、80℃の環境下において、他方の試験用電極板によって異方導電性コネクタにおける弾性異方導電膜をその厚み方向に接続用導電部の歪み率が20%となるよう加圧し、当該接続用導電部における導通抵抗および絶縁抵抗を測定した。更に、異方導電性コネクタに対する加圧を3000時間保持した後、当該接続用導電部における導通抵抗および絶縁抵抗を測定した。

初期の導通抵抗の平均値、最大値、最小値および絶縁抵抗の最小値、並びに3000時間経過後の導通抵抗の平均値、最大値、最小値および絶縁抵抗の最小値を下記表3に示す。

#### 【0085】

##### 試験4：

図11に示すように、一面における中央領域に、それぞれ表面に金メッキを施した複数のパターン電極101が弾性異方導電膜15の接続用導電部16のパターンと同一のパターンに従って形成され、当該一面における周縁領域に、当該パターン電極101の各々にプリント配線（図示省略）によって電氣的に接続された複数のリード電極102が形成された、異方導電性コネクタ10より大きい寸法の一方の試験用電極板100と、一面全面に金メッキよりなる共通電極106が形成された、異方導電性コネクタ10より大きい寸法の他方の試験用電極板105とを用意し、一方の試験用電極板100上に異方導電性コネクタ10をその接続用導電部16の各々が当該一方の試験用電極板100のパターン電極101上に位置するよう位置合わせした状態で配置し、この異方導電性コネクタ

ー 10 における弾性異方導電膜 15 上に、他方の試験用電極板 105 を配置し、一方の試験用電極板 100 における各リード電極 102 および他方の試験用電極板 105 における共通電極 106 を、電圧計 110 に電氣的に接続すると共に、この電圧計 110 とは並列に、定電流制御装置 116 を介して直流電源 115 に電氣的に接続し、更に、一方の試験用電極 100 と他方の試験用電極 105 との間に、異方導電性コネクター 10 における弾性異方導電膜 15 の全厚の 80% の厚みを有する電氣的に絶縁性の枠状のスペーサー 120 を配置した。

次いで、室温環境下において、他方の試験用電極板 105 の他面におけるスペーサー 120 の外側の位置において、当該他方の試験用電極板 105 をその厚み方向に加圧して当該異方導電性コネクター 10 を圧縮変形させることにより、当該他方の試験用電極板 105 の共通電極 106 をスペーサー 120 に接触させた。この状態において、異方導電性コネクター 10 における接続用導電部 16 の歪み率は 20% である。

次いで、直流電源 115 および定電流制御装置 116 によって異方導電性コネクター 10 の接続用導電部 16 の一つに 1 A の直流電流を 20 秒間印加した後、当該接続用導電部 16 における電圧を電圧計 110 によって測定した。この電圧の測定を全ての接続用導電部 16 に対して順次行った。そして、接続用導電部 16 に印加した直流電流を  $I_2$  ( $= 1 \text{ A}$ ) とし、測定した接続用導電部 16 における電圧の値 (V) を  $V_2$  として、下記の数式により、導通抵抗  $R_2$  を求めた。また、上記試験 3 と同様にして異方導電性コネクター 10 の接続用導電部 16 を 3000 時間加圧した後、当該異方導電性コネクター 10 の導通抵抗  $R_2$  を上記と同様にして求めた。この導通抵抗  $R_2$  の値が  $100 \text{ m}\Omega$  以下のとき、当該接続用導電部 16 の許容電流値が 1 A 以上である。導通抵抗  $R_2$  の平均値を下記表 3 に示す。

試験 3 および試験 4 において、異方導電性コネクター 10 の接続用導電部 16 を歪み率 20% となるよう他方の試験用電極板を加圧した場合に、当該他方の試験用電極板の加圧による変形が大きいときには、当該他方の試験用電極板が破損する恐れがあるため、加圧による試験用電極板の変形 (反り) が  $0.1 \text{ mm}$  以上生じたときには、試験の続行を中止した。

【 0 0 8 6 】

【 数 3 】

$$R_2 = V_2 / I_2$$

【 0 0 8 7 】

【表3】

	試験3										試験4	
	初期					3000時間経過後					導通抵抗R <sub>2</sub> (mΩ)	
	導通抵抗				絶縁抵抗 の最小値 (Ω)	導通抵抗				絶縁抵抗 の最小値 (Ω)	初期	3000 時間加圧 後
	平均値 (mΩ)	最大値 (mΩ)	最小値 (mΩ)	変動係数 (%)		平均値 (mΩ)	最大値 (mΩ)	最小値 (mΩ)	変動係数 (%)			
実施例1	32	51	22	26	>10M	34	56	28	27	>10M	35	47
実施例2	37	58	31	24	>10M	41	65	35	25	>10M	40	51
比較例1	試験せず											
比較例2	76	135	31	65	>10M	124	282	83	52	>10M	70	134
比較例3	試験中止											

【0088】

表2および表3から明らかなように、実施例1～2に係る異方導電性コネクタ

一によれば、良好な電氣的接続状態が得られると共に、高温環境下において長時間使用した場合でも、良好な電氣的接続状態が安定に維持されることが理解される。

これに対し、比較例 1 に係る異方導電性コネクタは、弾性異方導電膜を支持するフレームがポリエチレンテレフタートよりなるため、弾性異方導電膜を形成工程において、シリコンゴムの硬化収縮によってフレーム板が大きく変形しており、試験用電極板の電極の位置合わせ、固定が困難であった。

また、比較例 2 に係る異方導電性コネクタは、接続用導電部中に含有される導電性粒子の粒子径が大きいものであるため、各接続用導電部間において厚み方向の導電性がバラツキが大きく、また長時間使用した場合には、接続用導電部の電気抵抗値が増加し、安定な電氣的接続が維持されなかった。

また、比較例 3 に係る異方導電性コネクタは、接続用導電部のデュロメータ硬度が高いため、加圧によって試験用電極板を変形させることなしに、異方導電性コネクタの接続用導電部をその歪み率が 20 % となるよう加圧することが困難であった。このような異方導電性コネクタは、ウエハ検査装置に使用した場合において、検査用回路基板と接続用回路基板とを、検査用回路基板および接続用回路基板を変形または破損させることなしに電氣的接続を達成させることが困難であり、従って、実際の使用において問題がある。

#### 【0089】

##### 【発明の効果】

本発明の異方導電性コネクタによれば、弾性異方導電膜が金属材料よりなるフレーム板によって支持されているため、当該フレーム板を保持したときには異方導電性コネクタ全体が大きく変形することがなく、これにより、当該異方導電性コネクタの接続対象電極に対する位置合わせ作業を容易に行うことができる。

また、フレーム板を構成する金属材料は線熱膨張係数が小さいものであるため、温度環境の変化に対しても優れた寸法安定性を有し、これにより、良好な電氣的接続状態を安定に維持することができる。

また、弾性異方導電膜における接続用導電部には、デュロメータ硬さが特定

の範囲にある弾性高分子物質中に特定の導電性粒子が充填されてなるため、高い導電性が得られると共に、接続対象電極に対する安定な電氣的接続状態が得られる。

また、接続用導電部間における電気抵抗が10MΩ以上であるため、接続対象電極に対して高い接続信頼性が得られる。

従って、本発明の異方導電性コネクタは、ウエハ検査装置に好適に用いることができる。

#### 【0090】

また、本発明のウエハ検査装置によれば、ウエハに形成された多数の集積回路の電氣的検査を行うウエハ検査装置において、装置全体の小型化が可能で、検査用回路基板の使用寿命が短くなることがなく、多数の被検査電極についての検査を一括して行うことができ、良好な電気特性を有し、高機能の集積回路の電氣的検査を行うことができる。

#### 【図面の簡単な説明】

##### 【図1】

本発明に係る異方導電性コネクタの一例を示す平面図である。

##### 【図2】

図1に示す異方導電性コネクタのX-X断面図である。

##### 【図3】

図1に示す異方導電性コネクタにおけるフレーム板の平面図である。

##### 【図4】

図1に示す異方導電性コネクタにおける弾性異方導電膜を拡大して示す説明用断面図である。

##### 【図5】

弾性異方導電膜成形用の金型の一例における構成を示す説明用断面図である。

##### 【図6】

金型内に形成された成形材料層に強度分布を有する平行磁場が作用された状態を示す説明用断面図である。

##### 【図7】

弾性異方導電膜成形用の金型の他の例における構成を示す説明用断面図である。

【図 8】

本発明に係るウエハ検査装置の一例における構成を示す説明用断面図である。

【図 9】

図 8 に示すウエハ検査装置における検査用回路基板と接続用回路基板との接続状態を示す説明用断面図である。

【図 10】

実施例において、試験 2 を行うために使用した装置の構成を示す説明図である。

【図 11】

実施例において、試験 4 を行うために使用した装置の構成を示す説明図である。

【図 12】

従来のウエハ検査装置の一例における構成を示す説明用断面図である。

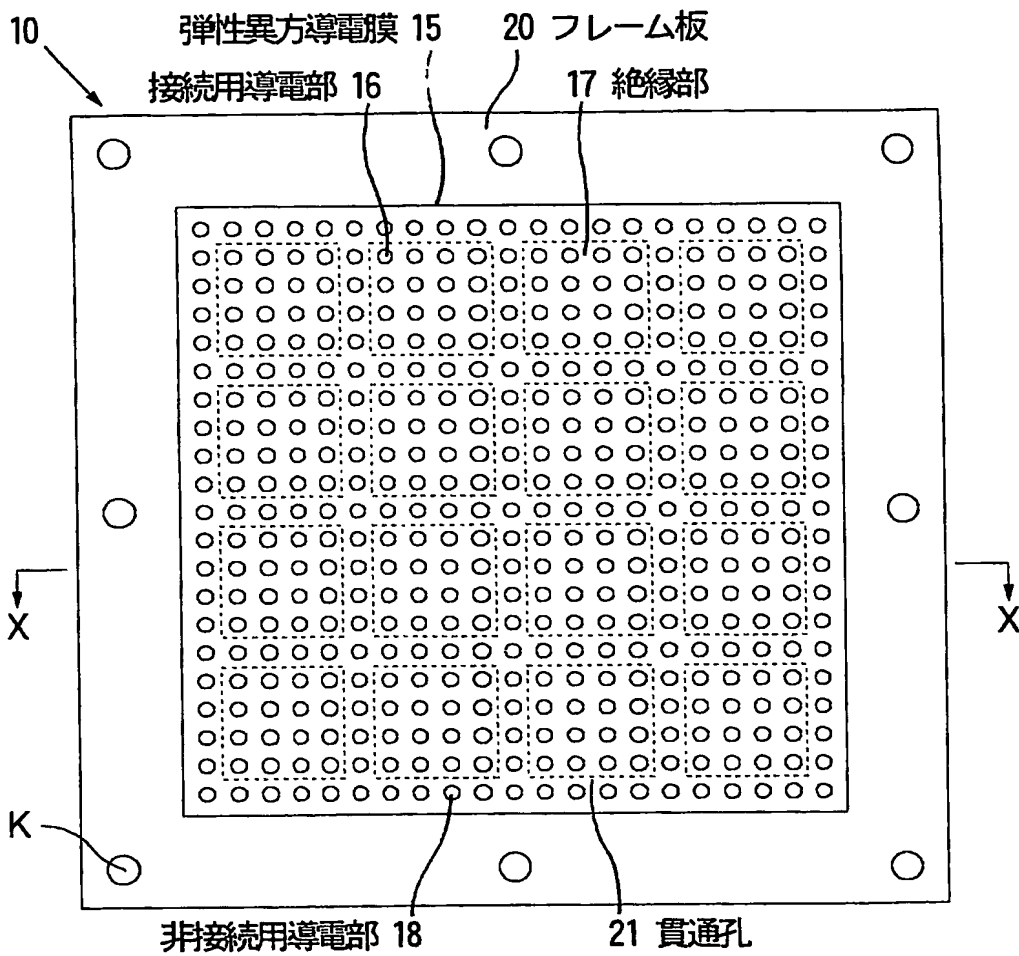
【符号の説明】

1	ウエハ	10	異方導電性コネクタ
15	弾性異方導電膜	15A	成形材料曹
16	接続用導電部	16A, 16B	突出部分
17	絶縁部	18	非接続用導電部
20	フレーム板	21	貫通孔
30	検査用回路基板	31	検査用電極
35	加圧機構	36	ウエハトレイ
40	プローブカード	41	接続用回路基板
42	端子電極	43	ガイドピン
45	接触部材		
50	金型	51	上型
52	強磁性体基板	53	非磁性体基板
53A	磁性部材収容用凹所		

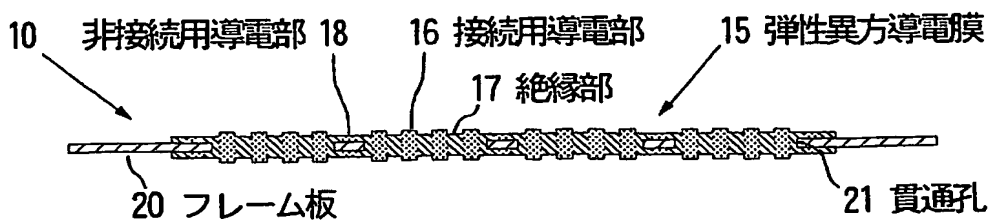
- 53B 突出部分形成用凹所
- 54A 球状の磁性部材    54B 蓋材
- 56 下型
- 57 強磁性体基板    58 非磁性体基板
- 58A 磁性部材収容用凹所
- 58B 突出部分形成用凹所
- 59A 球状の磁性部材    59B 蓋材
- 60 金型    61 上型
- 62 強磁性体基板    63 強磁性体層
- 64 非磁性体層
- 66 下型    67 強磁性体基板
- 68 強磁性体層    69 非磁性体層
- 80 検査用回路基板    81 検査用電極
- 85 コネクター    86 接続ピン
- 90 プロブカード    91 接続用回路基板
- 92 端子電極    93 ガイドピン
- 95 接触部材    96 ウエハトレイ
- 97 加圧機構    K 位置決め用孔
- P 導電性粒子
- 100 一方の試験用電極板
- 101 パターン電極    102 リード電極
- 105 他方の試験用電極板
- 106 共通電極    110 電圧計
- 115 直流電流    116 定電流制御装置
- 120 スペーサー

【書類名】 図面

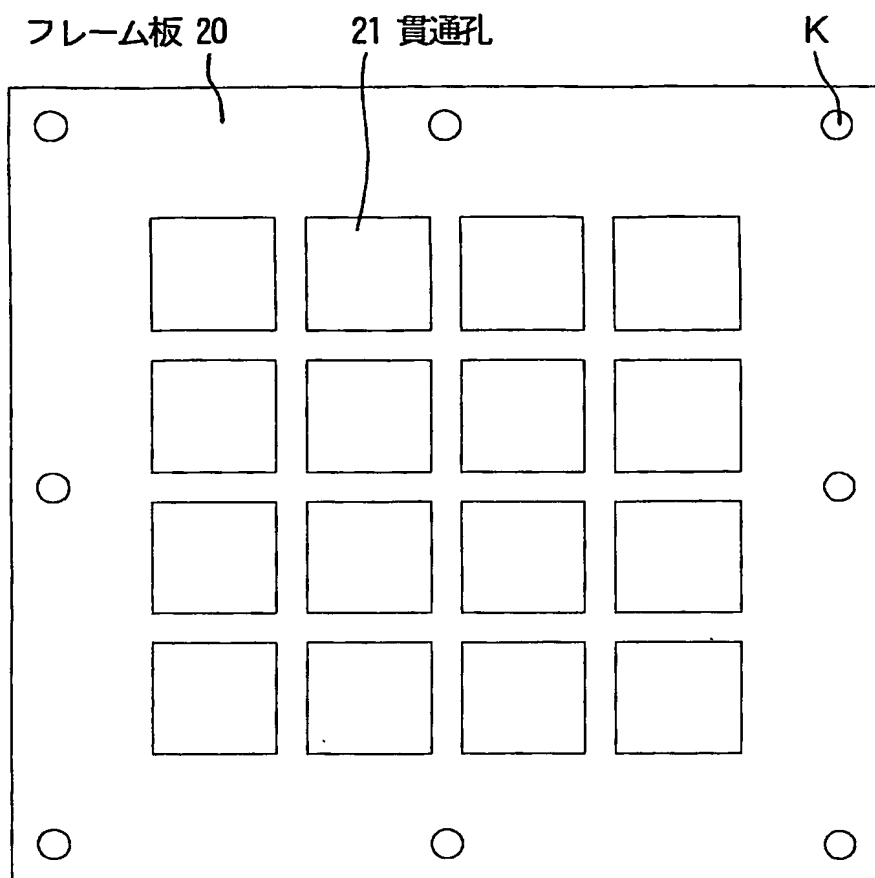
【図 1】



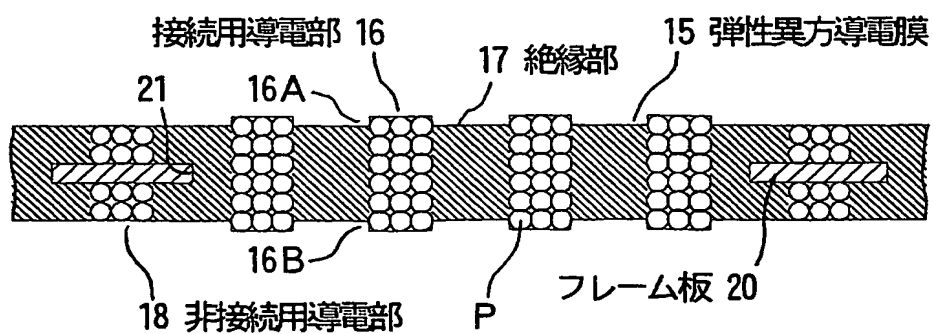
【図 2】



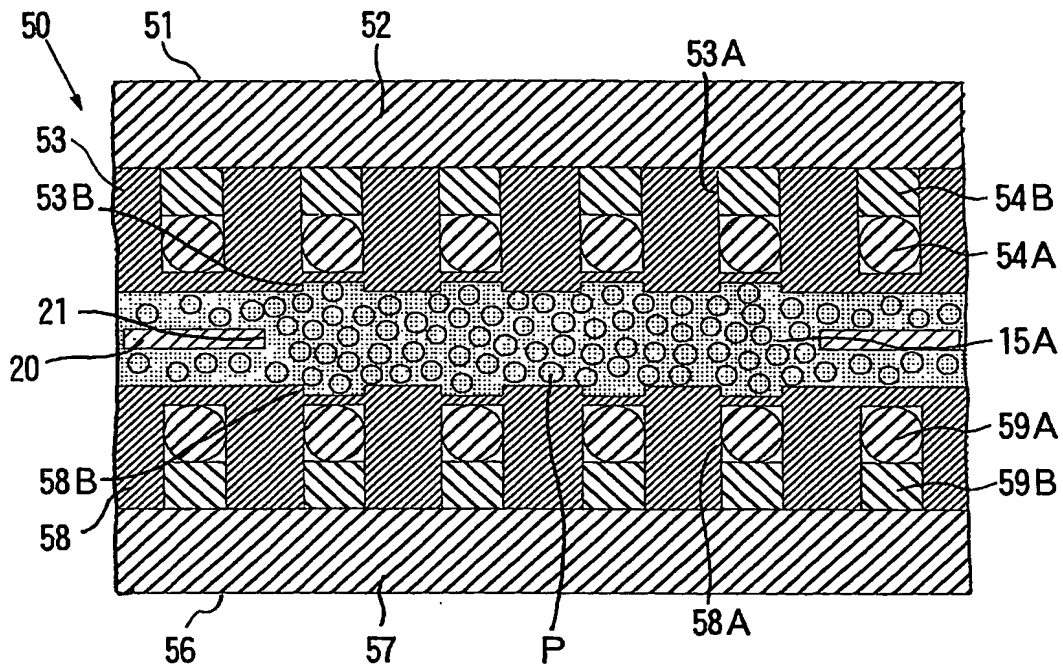
【図 3】



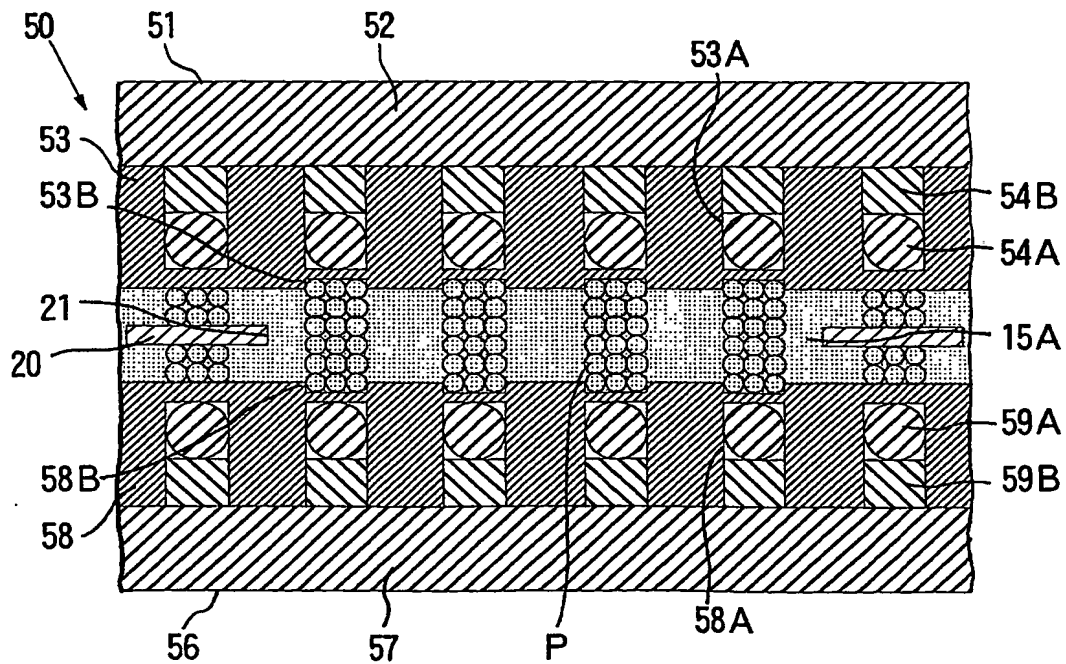
【図 4】



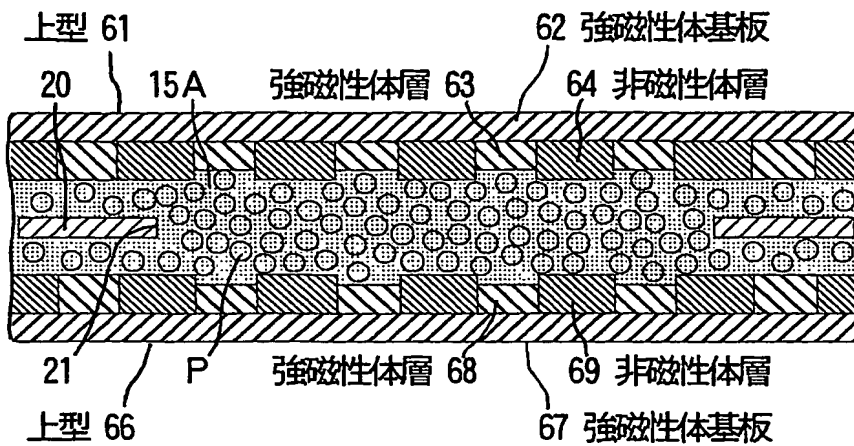
【図 5】



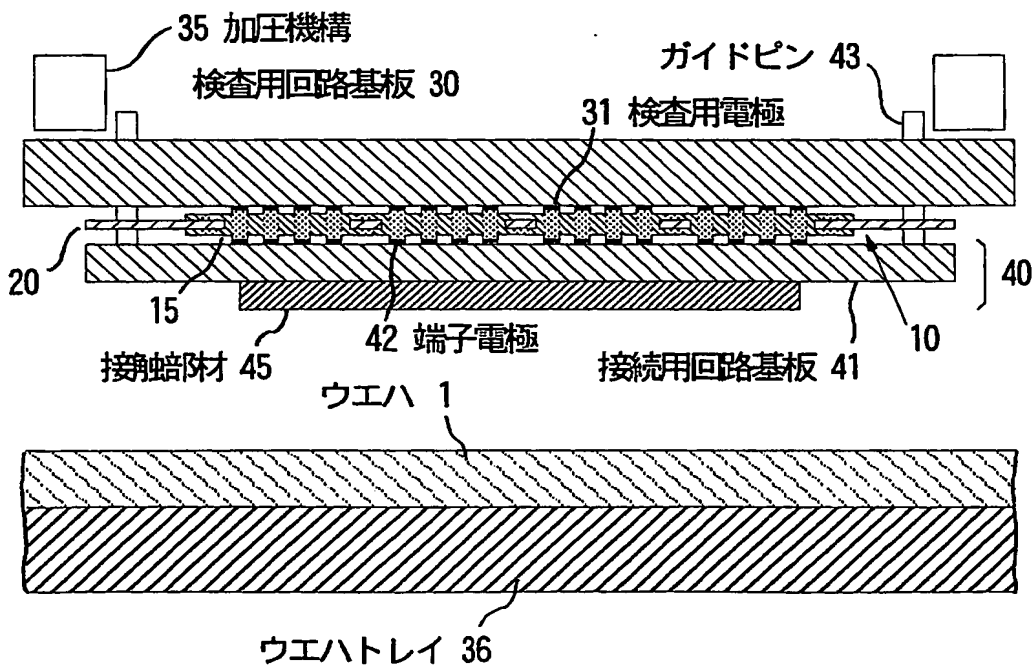
【図 6】



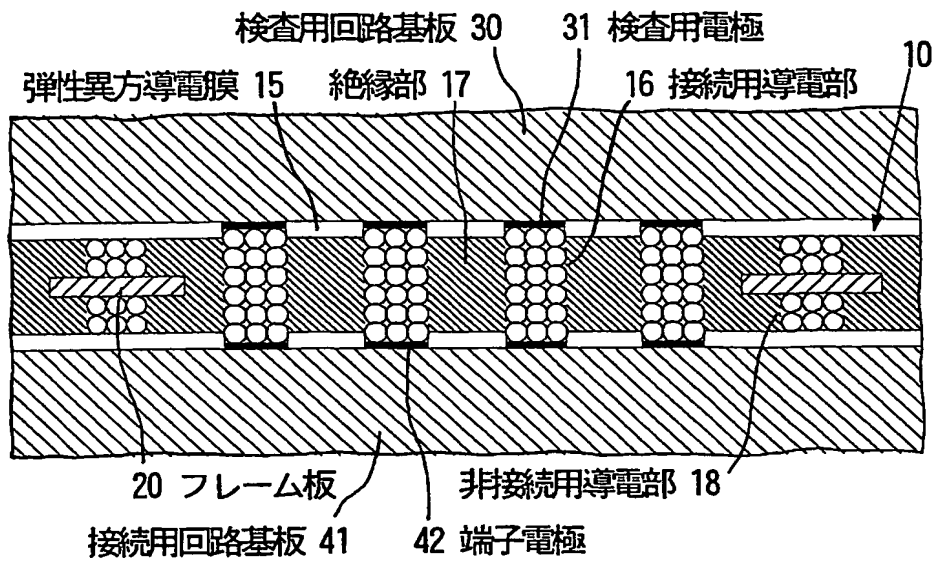
【図 7】



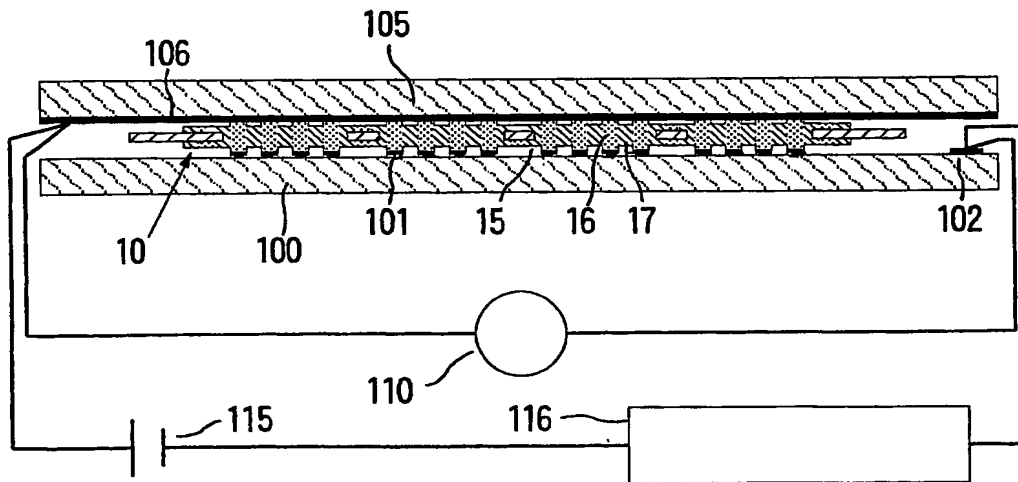
【図 8】



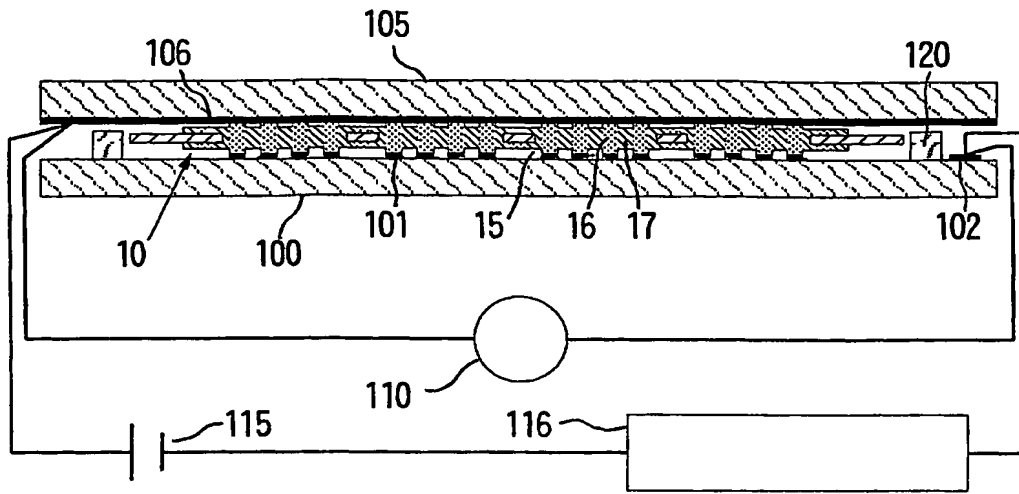
【図 9】



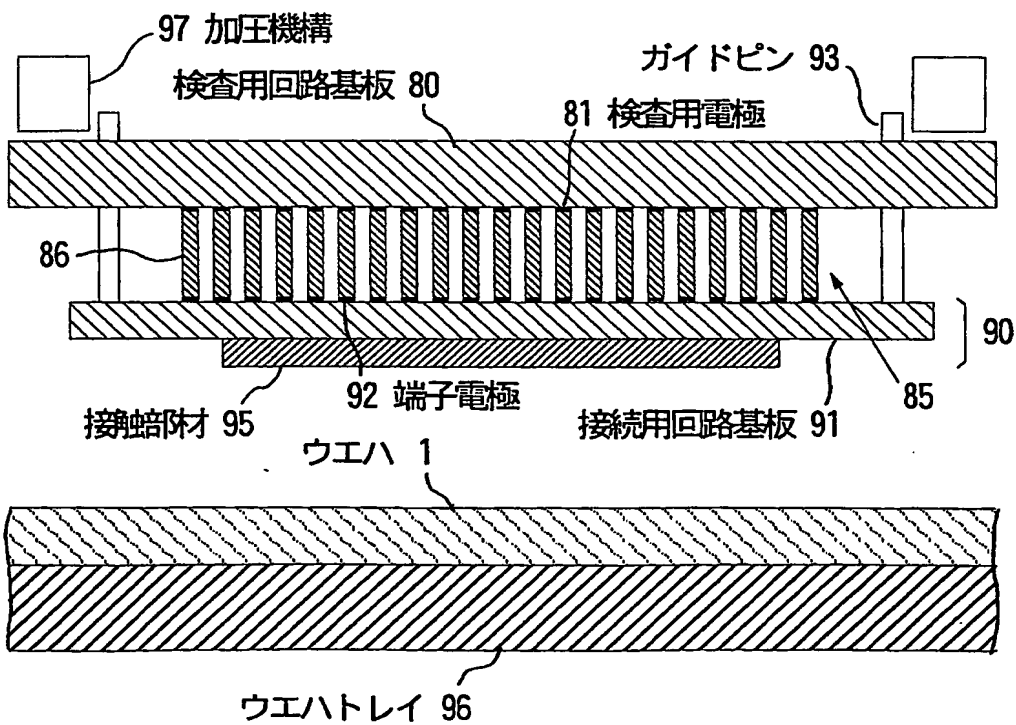
【図 10】



【図 1 1】



【図 1 2】



【書類名】 要約書

【要約】

【課題】 小型で、検査用回路基板の使用寿命が短くならず、多数の被検査電極の検査を一括して行うことができ、良好な電気特性を有し、高機能集積回路の電氣的検査が可能なウエハ検査装置およびこれに用いる異方導電性コネクタの提供。

【解決手段】 異方導電性コネクタは、互いに離間して配置された厚み方向に伸びる複数の接続用導電部およびこれらの間に形成された絶縁部よりなる弾性異方導電膜と、これを支持するフレーム板とよりなり、フレーム板は線熱膨張係数が  $3 \times 10^{-6} \sim 3 \times 10^{-5} \text{K}^{-1}$  の金属材料よりなり、接続用導電部は、弾性高分子物質中に数平均粒子径が  $20 \sim 80 \mu\text{m}$  の磁性を示す導電性粒子が密に充填されてなり、導電性粒子は、表面に厚みが  $20 \text{ nm}$  以上の貴金属よりなる被覆層が形成されてなり、接続用導電部のデュロメーター硬さが  $10 \sim 35$  であり、接続用導電部間における電気抵抗が  $10 \text{ M}\Omega$  以上である。

【選択図】 図 2

特願 2003-163866

出願人履歴情報

識別番号 [000004178]

1. 変更年月日 2003年 5月 6日  
[変更理由] 住所変更  
住 所 東京都中央区築地五丁目6番10号  
氏 名 ジェイエスアール株式会社
2. 変更年月日 2003年 9月 1日  
[変更理由] 名称変更  
住 所 東京都中央区築地五丁目6番10号  
氏 名 J S R 株式会社